

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

20.10.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2004年 4月30日

REC'D. 09 DEC 2004

出願番号
Application Number:

特願2004-136659

[ST. 10/C]: [JP2004-136659]

出願人
Applicant(s):

三井化学株式会社

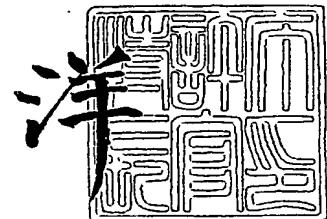
WIPO

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P0003296
【提出日】 平成16年 4月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B41M 5/26
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内
 【氏名】 上野 恵司
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内
 【氏名】 宮里 将敬
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内
 【氏名】 塩崎 裕由
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内
 【氏名】 石田 努
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦 580-32 三井化学株式会社内
 【氏名】 小木曾 章
【特許出願人】
 【識別番号】 000005887
 【氏名又は名称】 三井化学株式会社
 【代表者】 中西 宏幸
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 005278
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

レーザー光で記録再生が可能で、且つ、塗布法により形成可能な記録層（A）を少なくとも一層有する光記録媒体であって、記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{\max}^2 ）を記録後の該記録層（A）に与える有機化合物を少なくとも1種、該記録層（A）に含有する光記録媒体。

【請求項2】

吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）が記録再生波長（ λ_0 ）よりも短波長側にあり（ $\lambda_{\max}^1 < \lambda_0$ ）、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{\max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大することを特徴とする、請求項1記載の光記録媒体。

【請求項3】

記録再生波長（ λ_0 ）が300～500nmの範囲から選択される、請求項1～2のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項4】

記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{\max}^2 ）を記録後に与える有機化合物を少なくとも1種含有する組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】組成物および光記録媒体

【技術分野】

【0001】

本発明は、光記録媒体に関するものであり、特に可視レーザーの一種である青色レーザー光により記録再生可能である高密度光記録媒体に関する。

【背景技術】

【0002】

コンパクトディスク（以下、CDと略す）規格に対応した光記録媒体としてCD-R（CD-Recordable）が広く普及している。CD-Rの記憶容量は680MB程度であるが、情報量の飛躍的増加に伴い、情報記録媒体に対する高密度化および大容量化への要求は高まっている。

【0003】

記録媒体の高密度化を行う手段としては、記録再生に用いるレーザー波長の短波長化及び対物レンズの開口数（N. A. : Numerical Aperture）を大きくすることにより、ビームスポットを小さくすることが挙げられる。そして、光ディスクシステムに利用される短波長レーザーとして、500nm～700nm、さらには630nm～690nm前後、具体的には、680nm、670nm、660nm、650nm、635nm等の赤色レーザーが実用化されてきた。こうして半導体レーザーの短波長化、対物レンズの開口数大化、データ圧縮技術等により、動画記録及び大容量の情報の記録を可能にした光記録媒体の作製が可能となってきた。今日までに提案されている光記録媒体としては、光磁気記録媒体、相変化記録媒体、カルコゲン酸化物系光記録媒体、有機色素系光記録媒体等があるが、これらの中で、安価かつプロセス上容易であるという点から、有機色素系光記録媒体は優位性を有すると考えられる。こうした状況を踏まえ、CDよりも高密度でTV品質並の動画の記録再生が可能な光記録媒体として、普及しつつある市販のDVDビデオプレーヤーやDVD-ROMプレーヤーで再生できる、発振波長630～690nmの赤色半導体レーザーで記録を施すことが可能な追記型光記録媒体として開発されたのが、追記型のデジタル多目的ディスク（以下、DVD-Rと略す）である。DVD-Rは、3.9GBあるいは4.7GBの記録容量を有する一度書き込み可能な光記録媒体であり、特にここ最近となって、片面4.7GB容量のDVD-R媒体が市場に供給され始めている。該DVD-R媒体も、シアニン系色素、アゾ系色素等を記録層に用い、反射層を設けた積層構造を採用しており、0.6mm厚の基板を2枚貼り合わせたディスク構造を特徴としている。この容量に合った記録特性良好な光ディスクについて、現在では高速記録対応の媒体開発が活発に進められている。

【0004】

さらに、将来的にはより高密度な記録が求められることが予想され、その情報量はディスク1枚あたり15～30GBにも達すると予想される。その記録密度を実現する為の手段として、より波長の短いレーザーを使用することは避けられない。従って、将来の有機色素系光記録媒体に用いる記録用色素としては、300nm～500nmの波長範囲において良好な記録特性を有する色素が望まれる。

【0005】

ところで、有機色素を記録層としたDVD-Rよりも高密度記録可能な媒体に関して、特許文献1には、発振波長680nm以下のレーザーを用い、記録容量8GB以上の密度を達成したとの開示がある。該文献の提案では、10～177μm厚さの光透過層越しに0.7以上の高開口数を有する対物レンズで680nm以下のレーザー光を収束することで、8GB以上の大容量記録を達成している。

【0006】

その一方で、ここ近年、発振波長390～430nmの青色レーザーとしてGaN系材料を用いた410nmのレーザーや、半導体レーザーと光導波路素子の組合せによる波長425nmのSHGレーザーが開発されてきており、このようなレーザーに合わせた青色

半導体レーザー対応色素の開発が現在展開されている。

更に、1999年初頭から発振波長400～410nmの青紫色発光のGaN系半導体レーザーが試供（日亜化学工業）されるに当たり、片面15GB以上の更なる高密度容量を有するHDTV（high definition television）放送並の画質で、2時間程度の動画の記録が可能となる媒体（以下、HD-DVD-R媒体と称す）の検討が始まっている。この様な高密度容量を有するHD-DVD-R媒体では、現行放送並の画質であれば6時間程度の録画も可能であるため、家庭用VTRに代わる新しい記録メディアとしても注目されている。

【0007】

かかる中、次世代高密度光ディスクの統一規格「Blu-ray Disc」が日欧韓9社により策定され、発表された（2002年2月19日）。この規格によると、青紫色レーザーとN.A.=0.85の高開口レンズとを組み合わせ、12cm円板の片面に最大27GBの映像データを繰り返し記録・再生でき、同規格のレコーダを使えば、ディスク1枚にHDTV映像を2時間以上録画できるようになる。これは、現行放送NTSC方式の映像データなら録画時間は13時間以上に相当する。

【0008】

また、同規格のディスク厚みは1.2mmで、100μm程度の光透過層越しに形成された記録膜にレーザー光を合焦させるもので、23.3、25、27GBの3種類の記録容量が提案されている。さらに前述の規格に先立ち、青紫色レーザー、ならびにN.A.=0.85の高開口レンズを用いた記録媒体への有機色素の適用可能性について言及された。

【0009】

現在のところ、400nm～500nmの青色レーザーで記録できる有機色素化合物として、シアニン系色素化合物や、ポルフィリン系色素化合物の他、ポリエン系色素化合物、アゾ系色素化合物、ジシアノビニルフェニル化合物、クマリン化合物、ピリミジン化合物、ナフタロシアニン化合物、ヘテロ5員環化合物、ビスマゾール化合物、アミノピリジン化合物、ビスピリジニウム化合物、オキソノール化合物、スチリル化合物、アミノブタジエン化合物、金属キレート化合物、キノン化合物またはキノジメタン化合物、ヒドラン化合物、トリアジン化合物、カルボスチリル化合物またはナフチリジン化合物、縮合複素環化合物、およびスチルベン化合物等が提案されている。

【0010】

また、記録層形成用の有機色素としてポルフィリン系色素やシアニン系色素等を主とする記録層および銀を主体とする金属反射層の2層が構成された特許文献2に記載の光記録媒体や、媒体構成に工夫したものとして、青色レーザーに感應するシアニン系色素を含有した青色レーザー感應色素層ならびに赤色レーザー感應色素層を有することで、2波長領域の記録を可能とする特許文献3に記載の光記録媒体や、青色レーザー用色素および赤色レーザー用色素の2種の色素を混合することで2波長領域の記録を可能とするインジゴイド系色素化合物を用いた特許文献4に記載の光記録媒体、シアノエテン系色素を用いた特許文献5に記載の光記録媒体、スクアリリウム系色素化合物を用いた特許文献6に記載の光記録媒体等が提案されている。

【0011】

一方、400～500nmの青色領域で有機色素膜を記録に行う例として、ポルフィリン系化合物の中心金属に配位する分子化合物および高分子、あるいは中心金属を配位する分子構造を側鎖に有する高分子と混合することで、該ポルフィリン系化合物のソーレー（Soret）帯を長波長側にシフトさせて、488nmのArレーザーに対応させると共に、スピントーニングによる成膜を可能ならしめて製造コストの低減を図る提案がなされている（特許文献7、8）。又、ポリエン系色素化合物（特許文献9、10）は、本発明者らの検討によれば、光安定性が悪く、実用化にはクエンチャーブレンド等の工夫が必要である。

【特許文献1】特開平10-302310号公報

出証特2004-3107462

- 【特許文献2】特開平11-53758号公報
- 【特許文献3】特開平11-203729号公報
- 【特許文献4】特開平11-78239号公報
- 【特許文献5】特開平11-105423号公報
- 【特許文献6】特開平11-110815号公報
- 【特許文献7】特開平7-304256号公報
- 【特許文献8】特開平7-304257号公報
- 【特許文献9】特開平4-78576号公報
- 【特許文献10】特開平4-89279号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

最近の状況として、波長400nm～410nmの青紫色半導体レーザーの実用化に目処がついたことで、該レーザーを用いた大容量追記型光記録媒体が盛んに開発され、特に高耐光性や良好な高速記録特性を有する色素の開発が望まれている。

【0013】

しかしながら、前述の光記録媒体では波長400nm～410nmのレーザー光に対して十分に適応していないのが実情である。すなわち、前述の有機色素を使用した媒体では、記録した信号の再生について、搬送波と雑音の比（C/N）が必ずしも良好な値でないために、信号の読み出しが必ずしも満足に行えない等の問題を我々は見出した。この問題を克服し、波長400nm～410nmのレーザー光で高密度記録再生可能な光記録媒体の開発が急務となっている。

【0014】

上記のように、該レーザーを用いた大容量光記録媒体が盛んに開発され、特に高耐光性や良好な高速記録特性を有する色素の開発が望まれているにもかかわらず、該波長領域のレーザー光に対して記録再生が可能な記録材料として前述の色素化合物は、今だ十分な特性が得られておらず、改善の余地があるのが現状である。また、記録膜形成が簡便なスピンドルコート法等の塗布法による媒体製造の際には、有利な特性の1つとして、塗布溶媒への高溶解性を有することが挙げられ、この点についても配慮することが必要である。また、一般に、記録容量の増大を図るには、より高密度に記録を行う必要があり、そのため、記録に使用する光学ビームを絞るための対物レンズの開口数を高め、光学系のレーザー波長をより短波長化することが必須となる。ところが、絞り込んだ光学ビームは回折限界でその最小のビーム径が定められる。さらに高速記録特性を有するためには、記録時のレーザーパワーができる限り小さいことが重要である。すなわち、少ない記録レーザーエネルギーで良好な記録マークを形成し得る高感度な色素を開発することが重要である。

【0015】

ところで、記録はビーム強度がある閾値を超えたところで成されるので、図1(a)に示すように、絞り込んだビームスポットよりも小さな記録マークが得られる。この記録マークの周囲はビームの強度ピークのすそ野にあたるが、より短波長化が進む現況では、記録マークの周囲でも記録層の光化学反応を助長し、殊に、前述の青紫色レーザーの波長領域では、有機化合物の光化学反応が容易に生じる波長領域となるため、記録時にはマークエッジが劣化し、信号特性が悪化するという問題がある。すなわち、図1(b)に示すように、本来矩形波に対応して形成せねばならない記録情報〔図1(b)の実線〕が、マークエッジの劣化によりブロードな波形〔図1(b)の破線部〕となってしまう。又、記録時と同一の青紫色レーザー波長で再生を行うと、再生光のような微弱な光照射でも光反応が促進され、再生の度に劣化が進むという問題もあり、前記特開平7-304256号公報、特開平7-304257号公報でも、記録光と再生光とを異なる波長、実質的には、再生光を記録光よりも長波長とする対策を講じねばならなくなり、結果として、十分な高密度化の要求に応えられないのが現状である。又、記録波長と再生光波長を異ならしめることは、記録装置と再生装置を個別に用意するか、1つの装置に2つの光学系及びその制

御系を設けなければならず、光記録媒体としての用途が限定されたり、装置の大型化、コストの増大を招き、汎用性の乏しいものとなってしまう。また、従来、CD-Rなどの光記録媒体においては、有機色素膜の融点、昇華点、相転移点或いは熱分解点などの物性上の明確な熱的閾値を境に記録のオン・オフが成されてきたものに対し、青紫色レーザー励起による光劣化モードの介在は、このコントラストを曖昧にし、とりわけ光学ビームよりも小さい細密記録マークを形成せねばならない高密度記録系においては、著しく記録信号品位を損なう懸念があった。

【0016】

さらに、記録マークの形成の際、必要以上の変形が行われる場合や、上述の光劣化によりコントラストが曖昧化した場合、光ディスクの半径方向に対して悪い影響、すなわち、隣接して記録される（あるいは記録された）トラック部位を侵食もしくは不明確化し、隣接トラックの記録信号品位を著しく損なわせることがわかってきた。ここで、特に高密度且つ高速記録の必要な光記録媒体では、複数のトラック（以下、マルチトラックと称す）上の記録マークの記録信号品位が良好であることは必須である。言い換えれば、ディスク全周にわたって、良好な信号品位が保たれることが必要であり、そのためには、單一トラックを記録した後、隣接するトラックを新たに記録しても、既に記録したトラックでの信号品位が劣化せず保持され、かつ後から記録した隣接トラックの信号品位もまた、劣化せず良好に保持されることが必要となっている。そのため、記録マーク形成の際、必要以上の変形や光劣化モードを抑制して隣接トラックの記録信号品位を保つと共に、形成した記録マークが明確に認識できるような記録モードの開発が今や不可欠となっている。

【0017】

本発明の目的は、波長300nm～900nmの範囲のレーザー光、特に波長390nm～430nmの範囲のレーザー光、殊に波長400nm～410nmの範囲から選択される青紫色のレーザー光で良好な記録および再生が可能な超高密度記録に適した記録層を有する光記録媒体を提供することにある。また、該光記録媒体に好適に使用できる新規な組成物を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0018】

本発明者らは、上記課題を解決すべく銳意検討を重ねた結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、

1. レーザー光で記録再生が可能で、且つ、塗布法により形成可能な記録層（A）を少なくとも一層有する光記録媒体であって、記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{max}^2 ）を記録後の該記録層（A）に与える有機化合物を少なくとも1種、該記録層（A）に含有する光記録媒体、
2. 吸収極大波長（ λ_{max}^1 ）が記録再生波長（ λ_0 ）よりも短波長側にあり（ $\lambda_{max}^1 < \lambda_0$ ）、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大することを特徴とする1記載の光記録媒体、
3. 記録再生波長（ λ_0 ）が300～500nmの範囲から選択される1又は2記載の光記録媒体、
4. 記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{max}^2 ）を記録後に与える有機化合物を少なくとも1種含有する組成物、

に関する。

【発明の効果】

【0019】

本発明によれば、本発明に係る記録レーザー光を吸収することで吸収極大波長が移動する有機化合物を少なくとも1種、塗布法で形成可能な記録層に含有することにより、波長300～900nmレーザー、特に高密度光記録媒体として非常に注目されている波長390～430nmレーザー、更には波長400～410nm青紫色レーザーを使用し、そ

の波長域での吸光度を増大することで高密度かつ高品位の信号の記録再生が可能な記録層を有する光記録媒体を提供することが可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

本発明は、光記録媒体の記録層中に本発明に係る有機化合物を含有することを特徴とする光記録媒体に関し、波長300nm～900nm、特に波長390nm～430nm、更には波長400nm～410nmの範囲から選択されるレーザー光により記録および再生が可能である新規な光記録媒体に関するものである。

【0021】

本発明に係る光記録媒体とは、情報を記録して再生することのできる光記録媒体を示すものである。但し、ここでは適例として基板上に記録層（A）、必要に応じて反射層を有する本発明の光記録媒体に関して説明する。尚、以下の説明では、光記録媒体として、光ディスクであって、支持基板上に例えば案内溝と、この案内溝上に、記録用材料として本発明に係る有機化合物を少なくとも1種有する記録層と、反射膜とを有し、波長300～900nmのレーザー光を照射して信号の記録再生を行う媒体に関して説明するが、本発明の光記録媒体は、この様な形状や構成に限定されるものではなく、カード状、シート状等その他各種の形状のもの、又、反射層を有さないもの、更に将来開発されるであろうより短波長のレーザーでの記録再生にも適用し得るものである。

【0022】

本発明の光記録媒体は、例えば、図2に示すような基板1、記録層2、反射層3、及び保護層4が順次積層している4層構造を有しているか、図3に示すような貼り合わせ構造を有している。即ち、基板1上に記録層2が形成されており、その上に密着して反射層3が設けられており、さらにその上に接着層5を介して保護層4が貼り合わされている。但し、記録層2の下または上に別の層があつても良く、反射層3の上に別の層があつても構わない。また、図4に示すように基板1、反射層3、記録層2、保護層4の順に積層し、保護層側から記録再生する構造であつても良い。また、特開平10-326435号公報記載のように光透過層の厚みが、光学系の開口数N.A. 及びレーザー波長λにより規定された媒体構造であつても構わない。

【0023】

また、本発明の光記録媒体は、必要に応じて特開平11-203729号公報記載のように記録層を2種以上有する構造であつても構わない。記録層を2種以上有する構造の光記録媒体に用いる光記録媒体とは、本発明に係る記録層（A）を2種以上有していてもよく、あるいは1つが本発明に係る記録層（A）であり、少なくとも1つが他の記録層（B）であつてもよい。他の記録層（B）としては、前述の公知の有機色素を1つ以上含有してなる記録層、あるいは、金属や半金属等の無機物を使用した公知の無機記録層などが挙げられる。また記録層（B）は2種以上あつてもよい。記録層（A）および記録層（B）は隣接していても、中間層により隔離されていてもよい。また、記録層（A）および記録層（B）は各々2種以上ある場合に、各々の位置関係は特に限定されず用いることができる。中間層としては、距離を隔てる目的で透明樹脂層であつてもよく、反射層、反射増幅層あるいは接着層を適宜有していても良い。また、各々の記録層と基板、あるいは各々の記録層と保護層との間に、それぞれ必要に応じて、反射層、反射増幅層あるいは接着層を有していても良い。

【0024】

また、本発明を光ディスクに適用した例として、図5に示すような、基板11、記録層12、反射層13及び保護層14がこの順で積層され、更に接着層を兼ねる保護層14上にダミー基板15を貼り合わせたものが挙げられる。もちろん、基板15の無い構成であつても良く、基板11と記録層12の間、記録層12と反射層13の間、反射層13と保護層14との間、保護層14とダミー基板15との間に、他の層が存在していても良い。図5の光ディスクにおいては、基板11側から記録再生が行われる。

【0025】

又、別の実施形態として、特開平10-302310号公報に開示の構成、例えば、図6に示すように、案内溝の形成された支持基板11'上に、反射層13'、有機色素を主成分とする記録層12'がこの順で成膜され、この記録層12'上に任意に形成される透明保護層14'を介して光透過層15'が形成され、情報の記録及び再生は、光透過層15'側から実施される。尚、逆に光透過層15'側に案内溝を形成し、その上に透明保護層14'、記録層12'、反射層13'を積層し、支持基板11'と貼り合わせる構成としても良い。

【0026】

あるいは、さらに別の実施形態として、特開2002-175645号公報に開示の構成、例えば、図7に示すように、案内溝の形成された支持基板21上に、記録層22が成膜され、この記録層22上に塗化物層23、酸化物層24を順次積層してなる誘電体層40を形成し、さらに誘電体層40上に、粘着剤を必要に応じて介し、光透過層25が形成され、情報の記録および再生は、光透過層25側から実施される。尚、逆に光透過層25側に案内溝を形成し、その上に酸化物層24、塗化物層23を順次積層してなる誘電体層40、記録層22を積層し、支持基板21と貼り合わせる構成としてもよい。このように、反射層を用いず、情報記録層上に誘電体層を形成して、多重干渉による光学的エンハンスメント効果を得ることで、適した初期反射率を得られる光記録媒体に本発明に係る有機化合物を適用可能である。

【0027】

本発明においては、基板上に記録層を設けるが、本発明に係る記録層(A)は、記録レーザー光の照射によって、該記録層(A)の記録前の吸収極大波長(λ_{max}^1)とは異なる吸収極大波長(λ_{max}^2)を記録後に得ることを特徴として挙げられる。具体的な例としては、吸収極大波長(λ_{max}^1)が記録再生波長(λ_0)よりも短波長側にあり($\lambda_{max}^1 < \lambda_0$)、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大する記録層、あるいは、吸収極大波長(λ_{max}^1)が記録再生波長(λ_0)よりも長波長側にあり($\lambda_{max}^1 > \lambda_0$)、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大する記録層が挙げられる。

【0028】

ここで本発明に係る吸収極大波長とは、該記録膜(A)の分光スペクトルにおける光吸収量が極大になる光波長を指す。また、本発明に係る記録用色素とは、着目のレーザー波長域で充分な吸収を有し、所定のエネルギーを有するレーザー光の照射により光・熱変換を伴って、物理的・化学的な変化、変質、分解して屈折率変化および/または形状変化することにより反射率の変化する部分(マーク)を形成できる色素である。また、本発明に係る有機化合物を用いることで、マルチトラック記録特性に優れる光記録媒体を得ることができる。

【0029】

本発明の光記録媒体は、特に300nm～900nmの範囲から選択される記録レーザー波長に対して記録再生が可能であり、中でも、波長390nm～430nmの範囲、更には波長400nm～410nmの範囲から選択される記録レーザー波長および再生レーザー波長に対して良好な信号特性が得られる光記録媒体である。また、少ない記録レーザーエネルギーで良好な記録マークを形成し得る高感度な記録層を有する光記録媒体を得ることが可能である。

【0030】

本発明に係る有機化合物は、有機溶剤に可溶であり、置換基の選択により吸光係数を保持した状態で吸収波長を任意に選択することで、前記レーザー光の波長において、記録層に必要な光学定数を満足することが可能である。また、本発明の組成物とは、本発明に係る有機化合物を少なくとも1種、含有するものであり、塗布法により製膜して本発明に係る記録層(A)とすること可能である。さらに、記録層(A)が良好なマーク形状を得ることのできる極めて有用な組成物である。

【0031】

以下、本発明についてさらに詳細を述べる。

【0032】

本発明の光記録媒体においては、記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{\max}^2 ）を記録後に与える有機化合物より1種以上の化合物を記録層（A）に含有する。

【0033】

本発明に係る有機化合物としては、好適には吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）が記録再生波長（ λ_0 ）よりも短波長側にあり（ $\lambda_{\max}^1 < \lambda_0$ ）、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{\max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大する性能を該記録膜（A）に与える有機化合物であり、より好ましくは記録層（A）における、記録再生波長より短波長側にあった吸収極大波長を記録後に5 nm～100 nm長波長化せしめる有機化合物で、且つ、塗布法に用いる溶剤に可溶であれば、特に制限なく1種または2種以上を用いても良い。なお、好ましい移動波長量は20 nm～40 nmが挙げられる。

【0034】

本発明の光記録媒体においては基板上に少なくとも1つ記録層を設けるが、該記録層のうち少なくとも1つは、本発明に係る有機化合物を少なくとも1種含有する記録層（A）である。また、本発明の光記録媒体を構成している記録層（A）は、実質的に1種またはそれ以上の本発明に係る有機化合物からなる本発明の組成物であることが好ましい。本発明の組成物中に含有する本発明に係る有機化合物の含有量は、記録再生が可能な任意の量を選択することができるが、通常、30%以上、好ましくは60%以上である。尚、実質的に100%であることも好ましい。

【0035】

本発明の組成物中には、本発明に係る有機化合物の他に、波長290 nm～690 nmに吸収極大を持ち、300 nm～900 nmでの屈折率が大きい前記以外の化合物を混合しても良い。また、必要に応じて、クエンチャー、化合物熱分解促進剤、紫外線吸収剤、接着剤、吸熱性又は吸熱分解性化合物、あるいは溶解性を向上させる高分子等の添加剤を混合してもよく、あるいは、そのような効果を有する化合物を本発明に係る有機化合物の置換基として導入することも可能である。本発明の組成物中において、これらの化合物の混合割合は、通常30質量%以下である。

【0036】

クエンチャーの具体例としては、アセチルアセトナト系化合物、ビスジチオ- α -ジケトン系化合物やビスフェニルジチオール系化合物等のビスジチオール系化合物、チオカテコナール系化合物、サリチルアルデヒドオキシム系化合物、チオビスフェノレート系化合物等の金属錯体が好ましい。また、アミン系化合物も好適である。

【0037】

化合物熱分解促進剤としては、熱減量分析（TG分析）等により、化合物の熱分解の促進が確認できるものであれば特に限定されず、例えば、金属系アンチノッキング剤、メタロセン化合物、アセチルアセトナト系金属錯体等の金属化合物が挙げられる。

【0038】

吸熱性又は吸熱分解性化合物としては、特開平10-291366号公報記載の化合物、又は、該公報に記載される置換基を有する化合物等が挙げられる。

【0039】

上述した各種のクエンチャー、化合物熱分解促進剤及び吸熱性又は吸熱分解性化合物は、必要に応じて、1種類で用いても、2種類以上を混合して用いても良い。

【0040】

さらに、必要に応じて、バインダー、レベリング剤、消泡剤等の添加物質を加えても良い。好ましいバインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ケトン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリオレフィン等が挙げられる。

【0041】

記録層（A）を基板の上に成膜する際に、基板の耐溶剤性や反射率、記録感度等を向上させるために、基板の上に無機物やポリマーからなる層を設けても良い。

【0042】

記録層（A）を設ける際の塗布方法として、例えば、スピンドル法、スプレー法、キャスト法、スライド法、カーテン法、エクストルージョン法、ワイヤー法、グラビア法、スプレッド法、ローラーコート法、ナイフ法、浸漬法等の塗布法等が挙げられるが、スピンドル法が簡便で好ましい。

【0043】

スピンドル法等の塗布法を用いる場合には、本発明に係る有機化合物を1～40質量%、好ましくは3～30質量%となるように溶媒に溶解あるいは分散させた塗布液を用いるが、この際、溶媒は基板にダメージを与えないものを選ぶことが好ましい。塗布法に用いる溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、アリルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、テトラフルオロプロパノール、オクタフルオロペントナノール等のアルコール系溶媒、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン等の脂肪族または脂環式炭化水素系溶媒、トルエン、キレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、四塩化炭素、クロロホルム、テトラクロロエタン、ジブロモエタン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン等のエーテル系溶媒、アセトン、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブタノン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、乳酸メチル等のエステル系溶媒、水等が挙げられる。これらは単独で用いても良く、あるいは、複数混合しても良い。好ましい溶剤としては、大気圧下での沸点が150℃以下のものが、塗布後の乾燥が速く、本発明の光記録媒体を製造する上で好ましい。さらには、大気圧下での沸点が150℃以下のアルコール系溶媒、特にフッ素置換アルコールがより好ましい。具体的にはテトラフルオロプロパノール、オクタフルオロペントナノールが好適な例として挙げられる。

【0044】

本発明に係る有機化合物については、特に、上述のフッ素置換アルコールに通常1質量%以上、好ましくは10質量%以上、更には20質量%以上となるように溶解するが好ましい。

【0045】

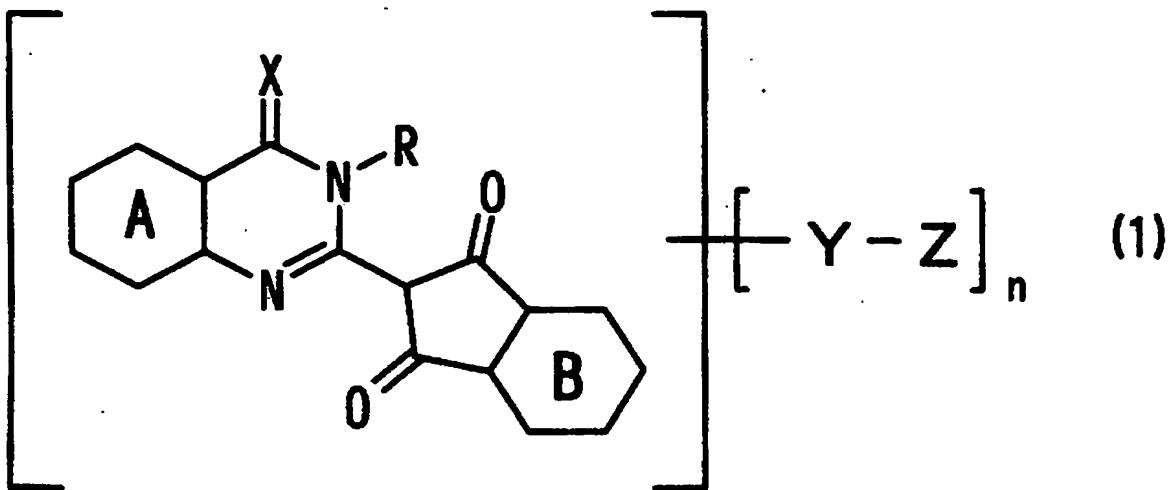
本発明に係る有機化合物としては、記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{max}^2 ）を記録後に与える有機化合物、好ましくは吸収極大波長（ λ_{max}^1 ）が記録再生波長（ λ_0 ）よりも短波長側にあり（ $\lambda_{max}^1 < \lambda_0$ ）、記録レーザー光の照射によって吸収極大波長が λ_{max}^2 に変化することで λ_0 での吸光度が増大する性能を該記録膜（A）に与えうる有機化合物、より好ましくは記録層（A）における、記録再生波長より短波長側にあった吸収極大波長を記録後に5nm～100nm長波長化せしめる有機化合物であり、上述した特定の物性を満たすものであればよく、特に制限はない。

【0046】

本発明に係る有機化合物の好ましい例として、より具体的には、互変可能な構造の一つとして、下記一般式（1）で表される化合物を挙げることができる。

【0047】

【化1】



【0048】

(式中、環Aおよび環Bは置換または無置換の炭素環式芳香族環あるいは置換または無置換の複素環式芳香族環を表し、Rは水素原子または置換基を表し、Xは酸素原子または硫黄原子を表し、Yは連結基を表し、Zはヘテロ原子を少なくとも1個含有する環状の置換アルキル基が置換した置換アルキル基を表し、nは1以上の整数を表す。)

【0049】

一般式(1)で表される化合物において、環Aおよび環Bはそれぞれ独立に、置換または無置換の炭素環式芳香族環あるいは置換または無置換の複素環式芳香族環を表す。

【0050】

一般式(1)で表される化合物において、環Aおよび環Bは、好ましくは、炭素数6～26の置換または無置換の炭素環式芳香族環あるいは炭素数3～26の置換または無置換の複素環式芳香族環であり、より好ましくは、炭素数6～20の置換または無置換の炭素環式芳香族環あるいは炭素数3～20の置換または無置換の複素環式芳香族環である。

【0051】

環Aおよび環Bで表される芳香族環の具体例としては、例えば、置換または無置換のベンゼン環、置換または無置換のナフタレン環、置換または無置換のペンタレン環、置換または無置換のインダセン環、置換または無置換のアズレン環、置換または無置換のヘプタレン環、置換または無置換のビフェニレン環、置換または無置換のフェナントレン環、置換または無置換のアントラセン環、置換または無置換のフルオランテン環、置換または無置換のアセナフチレン環、置換または無置換のトリフェニレン環、置換または無置換のピレン環、置換または無置換のクリセン環、置換または無置換のナフタセン環、置換または無置換のプレニアデン環、置換または無置換のピセン環、置換または無置換のペリレン環、置換または無置換のペンタフェン環、置換または無置換のペンタセン環、置換または無置換のテトラフェニレン環、置換または無置換のヘキサフェン環、置換または無置換のヘキサセン環、置換または無置換のルビセン環、置換または無置換のコロネン環、置換または無置換のトリナフチレン環、置換または無置換のヘプタフェン環、置換または無置換のヘプタセン環、置換または無置換のピランスレン環、置換または無置換のオヴァレン環等の炭素環式芳香族環；

置換または無置換のフラン環、置換または無置換のチオフェン環、置換または無置換のピロール環、置換または無置換のピラゾール環、置換または無置換のイミダゾール環、置換または無置換のオキサゾール環、置換または無置換のチアゾール環、置換または無置換のピリジン環、置換または無置換のピリダジン環、置換または無置換のピリミジン環、置換または無置換のピラジン環、置換または無置換のキノリン環、置換または無置換のイソ

キノリン環、置換または無置換のキノキサリン環、置換または無置換のインドリジン環、置換または無置換のインドール環、置換または無置換のインダゾール環、置換または無置換のプリン環、置換または無置換のフタラジン環、置換または無置換のナフチリジン環、置換または無置換のキナゾリン環、置換または無置換のシンノリン環、置換または無置換のブテリジン環、置換または無置換のカルボリン環、置換または無置換のフェナンスリジン環、置換または無置換のアクリジン環、置換または無置換のペリミジン環、置換または無置換のフェナントロリン環、置換または無置換のフェナジン環、置換または無置換のフラザン環等の複素環式芳香族環；

等が挙げられる。

【0052】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基としては、好ましくは、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換または無置換のアルキル基、置換または無置換のアラルキル基、置換または無置換のアリール基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換のアラルキルオキシ基、置換または無置換のアリールオキシ基、置換または無置換のアルキルチオ基、置換または無置換のアラルキルチオ基、置換または無置換のアリールチオ基、置換または無置換のアシル基、置換または無置換のアシルオキシ基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換または無置換のアラルキルオキシカルボニル基、置換または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換または無置換のアミノ基、あるいはメタロセニル残基を有する基である。

【0053】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の具体例としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基が挙げられ、

【0054】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアルキル基の具体例としては、

メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、ネオペンチル基、1, 2-ジメチルプロピル基、1, 1-ジメチルプロピル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペンチル基、3, 3-ジメチルブチル基、2, 3-ジメチルブチル基、1, 3-ジメチルブチル基、2, 2-ジメチルブチル基、1, 2-ジメチルブチル基、1, 1-ジメチルブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1, 2, 2-トリメチルブチル基、1, 1, 2-トリメチルブチル基、1-エチル-2-メチルプロピル基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2, 4-ジメチルペンチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2, 5-ジメチルヘキシル基、2, 5, 5-トリメチルペンチル基、2, 4-ジメチルヘキシル基、2, 2, 4-トリメチルペンチル基、3, 5, 5-トリメチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4, 5-メチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1, 3, 5, 7-テトラエチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、6, 6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4-ブチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペントアデシル基、3, 5-ジメチルヘプチル基、2, 6-ジメチルヘプチル基、2, 4-ジメチルヘプチル基、2, 2, 5, 5-テトラメチルヘキシル基、1-シクロヘンチル-2, 2-ジメチルプロピル基、1-シクロヘキシル-2, 2-ジメチルプロピル基等の無置換のアルキル基；

クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-ブロモエチル基、2-ヨードエチル基、ジクロロメチル基、フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペントフルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、2, 2, 2-トリクロロエチル基、1, 1, 1, 3, 3-ヘキサフルオロー-2-ブロピル基、ノナフルオロブチル

基、パーグルオロデシル基等のハロゲン原子で置換されたアルキル基；

ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピル基、4-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシ-3-メトキシプロピル基、2-ヒドロキシ-3-クロロプロピル基、2-ヒドロキシ-3-エトキシプロピル基、3-ブチルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシ-3-シクロヘキシルオキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシデカリル基等のヒドロキシル基で置換されたアルキル基；

ヒドロキシメトキシメチル基、ヒドロキシエトキシエチル基、2-(2'-ヒドロキシ-1'-メチルエトキシ)-1-メチルエチル基、2-(3'-フルオロー-2'-ヒドロキシプロピルオキシ)エチル基、2-(3'-クロロー-2'-ヒドロキシプロピルオキシ)エチル基、ヒドロキシブチルオキシシクロヘキシル基等のヒドロキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

ヒドロキシメトキシメチル基、ヒドロキシエトキシエトキシエチル基、[2'-(2'-ヒドロキシ-1'-メチルエトキシ)-1'-メチルエトキシ]エトキシエチル基、[2'-(2'-フルオロー-1'-ヒドロキシエトキシ)-1'-メチルエトキシ]エトキシエチル基、[2'-(2'-クロロー-1'-ヒドロキシエトキシ)-1'-メチルエトキシ]エトキシエチル基等のヒドロキシアルコキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基、2-シアノ-3-メトキシプロピル基、2-シアノ-3-クロロプロピル基、2-シアノ-3-エトキシプロピル基、3-ブチルオキシ-2-シアノプロピル基、2-シアノ-3-シクロヘキシルプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シアノブチル基等のシアノ基で置換されたアルキル基；

メトキシメチル基、エトキシメチル基、n-プロピルオキシメチル基、n-ブチルオキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、n-プロピルオキシエチル基、n-ブチルオキシエチル基、(4-メチルペンチルオキシ)エチル基、(1,3-ジメチルブチルオキシ)エチル基、(2-エチルヘキシルオキシ)エチル基、n-オクチルオキシエチル基、(3,5,5-トリメチルヘキシルオキシ)エチル基、(2-メチル-1-イソプロピルプロピルオキシ)エチル基、(3-メチル-1-イソプロピルブチルオキシ)エチル基、2-エトキシ-1-メチルエチル基、3-メトキシプロピル基、(3,3,3-トリフルオロプロピルオキシ)エチル基、(3,3,3-トリクロロプロピルオキシ)エチル基等のアルコキシ基で置換されたアルキル基；

メトキシメトキシメチル基、メトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、n-プロピルオキシエトキシエチル基、n-ブチルオキシエトキシエチル基、シクロヘキシルオキシエトキシエチル基、デカリルオキシプロピルオキシエトキシ基、(1,2-ジメチルブチルオキシ)エトキシエチル基、(3-メチル-1-イソブチルブチルオキシ)エトキシエチル基、(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)エチル基、(2-ブチルオキシ-1-メチルエトキシ)エチル基、2-(2'-エトキシ-1'-メチルエトキシ)-1-メチルエチル基、(3,3,3-トリフルオロプロピルオキシ)エトキシエチル基、(3,3,3-トリクロロプロピルオキシ)エトキシエチル基等のアルコキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

メトキシメトキシメチル基、メトキシエトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエトキシエチル基、n-ブチルオキシエトキシエトキシエチル基、シクロヘキシルオキシエトキシエチル基、n-プロピルオキシプロピルオキシプロピルオキシエチル基、(2,2,2-トリフルオロエトキシ)エトキシエトキシエチル基、(2,2,2-トリクロロエトキシ)エトキシエトキシエチル基等のアルコキシアルコキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

ホルミルメチル基、2-オキソブチル基、3-オキソブチル基、4-オキソブチル基、2,6-ジオキソシクロヘキサン-1-イル基、2-オキソ-5-tert-ブチルシクロヘキサン-1-イル基等のアシル基で置換されたアルキル基；

ホルミルオキシメチル基、アセトキシエチル基、n-プロピオニルオキシエチル基、n-ブタノイルオキシエチル基、バレリルオキシエチル基、(2-エチルヘキサノイルオキシ)エチル基、(3, 5; 5-トリメチルヘキサノイルオキシ)エチル基、(3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルオキシ)ヘキシル基、(3-フルオロブチリルオキシ)エチル基、(3-クロロブチリルオキシ)エチル基等のアシルオキシ基で置換されたアルキル基；

ホルミルオキシメトキシメチル基、アセトキシエトキシエチル基、n-プロピオニルオキシエトキシエチル基、バレリルオキシエトキシエチル基、(2-エチルヘキサノイルオキシ)エトキシエチル基、(3, 5, 5-トリメチルヘキサノイル)オキシブチルオキシエチル基、(3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルオキシ)エトキシエチル基、(2-フルオロプロピオニルオキシ)エトキシエチル基、(2-クロロプロピオニルオキシ)エトキシエチル基等のアシルオキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

アセトキシメトキシメトキシメチル基、アセトキシエトキシエトキシエチル基、n-プロピオニルオキシエトキシエトキシエチル基、バレリルオキシエトキシエチル基、(2-エチルヘキサノイルオキシ)エトキシエトキシエチル基、(3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルオキシ)エトキシエトキシエチル基、(2-フルオロプロピオニルオキシ)エトキシエトキシエチル基、(2-クロロプロピオニルオキシ)エトキシエトキシエチル基等のアシルオキシアルコキシアルコキシ基で置換されたアルキル基；

メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、n-ブチルオキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル基、エトキシカルボニルエチル基、n-ブチルオキシカルボニルエチル基、(4-エチルシクロヘキシルオキシカルボニル)シクロヘキシル基、(2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルオキシカルボニル)メチル基、(2, 2, 3, 3-テトラクロロプロピルオキシカルボニル)メチル基等のアルコキシカルボニル基で置換されたアルキル基；

フェニルオキシカルボニルメチル基、(2-メチルフェニルオキシカルボニル)メチル基、(3-メチルフェニルオキシカルボニル)メチル基、(4-メチルフェニルオキシカルボニル)メチル基、(4-tert-ブチルフェニルオキシカルボニル)メチル基、フェニルオキシカルボニルエチル基、(4-tert-ブチルフェニルオキシカルボニル)エチル基、(1-ナフチルオキシカルボニ)メチル基、(2-ナフチルオキシカルボニ)メチル基、(2-フェニルフェニルオキシカルボニル)エチル基、(3-フェニルフェニルオキシカルボニル)エチル基、(4-フェニルフェニルオキシカルボニル)エチル基等のアリールオキシカルボニルで置換されたアルキル基；

ベンジルオキシカルボニルメチル基、ベンジルオキシカルボニルエチル基、フェネチルオキシカルボニルメチル基、(4-シクロヘキシルオキシベンジルオキシカルボニル)メチル基等のアラルキルオキシカルボニル基で置換されたアルキル基；

ビニルオキシカルボニルメチル基、ビニルオキシカルボニルエチル基、アリルオキシカルボニルメチル基、シクロペンタジエニルオキシカルボニルメチル基、オクテノキシカルボニルメチル基等のアルケニルオキシカルボニル基で置換されたアルキル基；

メトキシカルボニルオキシメチル基、メトキシカルボニルオキシエチル基、エトキシカルボニルオキシエチル基、ブチルオキシカルボニルオキシエチル基、(2, 2, 2-トリフルオロエトキシカルボニルオキシ)エチル基、(2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニルオキシ)エチル基等のアルコキシカルボニルオキシ基で置換されたアルキル基；

メトキシメトキシカルボニルオキシメチル基、メトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、エトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、n-ブチルオキシエトキシカルボニルオキシエチル基、(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)エトキシカルボニルオキシエチル基、(2, 2, 2-トリクロロエトキシ)エトキシカルボニルオキシエチル基等のアルコキシアルコキシカルボニルオキシ基で置換されたアルキル基；

ジメチルアミノメチル基、ジエチルアミノメチル基、ジ-n-ブチルアミノメチル基、ジ-n-ヘキシルアミノメチル基、ジ-n-オクチルアミノメチル基、ジ-n-デシルアミノメチル基、N-イソアミル-N-メチルアミノメチル基、ピペリジノメチル基、ジ(

メトキシメチル) アミノメチル基、ジ(メトキシエチル) アミノメチル基、ジ(エトキシメチル) アミノメチル基、ジ(エトキシエチル) アミノメチル基、ジ(n-プロピルオキシエチル) アミノメチル基、ジ(ニーブチルオキシエチル) アミノメチル基、ビス(2-シクロヘキシルオキシエチル) アミノメチル基、ジメチルアミノエチル基、ジエチルアミノエチル基、ジ-n-ブチルアミノエチル基、ジ-n-ヘキシルアミノエチル基、ジ-n-オクチルアミノエチル基、ジ-n-デシルアミノエチル基、N-イソアミル-N-メチルアミノエチル基、ピペリジノエチル基、ジ(メトキシメチル) アミノエチル基、ジ(エトキシエチル) アミノエチル基、ジ(エトキシエチル) アミノエチル基、ジ(ニーブチルオキシエチル) アミノエチル基、ビス(2-シクロヘキシルオキシエチル) アミノエチル基、ジメチルアミノプロピル基、ジエチルアミノプロピル基、ジ-n-ブチルアミノプロピル基、ジ-n-ヘキシルアミノプロピル基、ジ-n-オクチルアミノプロピル基、ジ-n-デシルアミノプロピル基、N-イソアミル-N-メチルアミノプロピル基、ピペリジノプロピル基、ジ(メトキシメチル) アミノプロピル基、ジ(エトキシエチル) アミノプロピル基、ジ(エトキシメチル) アミノプロピル基、ジ(ニーブチルオキシエチル) アミノプロピル基、ジ(n-ブチルオキシエチル) アミノプロピル基、ビス(2-シクロヘキシルオキシエチル) アミノプロピル基、ジメチルアミノブチル基、ジエチルアミノブチル基、ジ-n-ブチルアミノブチル基、ジ-n-ヘキシルアミノブチル基、ジ-n-オクチルアミノブチル基、ジ-n-デシルアミノブチル基、N-イソアミル-N-メチルアミノブチル基、ピペリジノブチル基、ジ(メトキシメチル) アミノブチル基、ジ(エトキシエチル) アミノブチル基、ジ(エトキシメチル) アミノブチル基、ジ(ニーブチルオキシエチル) アミノブチル基、ジ(n-ブチルオキシエチル) アミノブチル基、ビス(2-シクロヘキシルオキシエチル) アミノブチル基等のジアルキルアミノ基が置換されたアルキル基；

アセチルアミノメチル基、アセチルアミノエチル基、n-プロピオニルアミノエチル基、n-ブタノイルアミノエチル基、シクロヘキシカルボニルアミノエチル基、4-メチルシクロヘキシカルボニルアミノエチル基、スクシンイミノエチル基等のアシルアミノ基で置換されたアルキル基；

メチルスルホンアミノメチル基、メチルスルホンアミノエチル基、エチルスルホンアミノエチル基、n-プロピルスルホンアミノエチル基、n-オクチルスルホンアミノエチル基等のアルキルスルホンアミノ基で置換されたアルキル基；

メチルスルホニルメチル基、エチルスルホニルメチル基、ブチルスルホニルメチル基、メチルスルホニルエチル基、エチルスルホニルエチル基、n-ブチルスルホニルエチル基、2-エチルヘキシスルホニルエチル基、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルスルホニルメチル基、2, 2, 3, 3-テトラクロロプロピルスルホニルメチル基等のアルキルスルホニル基で置換されたアルキル基；

フェニルスルホニルメチル基、フェニルスルホニルエチル基、フェニルスルホニルプロピル基、フェニルスルホニルブチル基、2-メチルフェニルスルホニルメチル基、3-メチルフェニルスルホニルメチル基、4-メチルフェニルスルホニルメチル基、4-メチルフェニルスルホニルエチル基、4-メチルフェニルスルホニルプロピル基、4-メチルフェニルスルホニルブチル基、2, 4-ジメチルフェニルスルホニルメチル基、2, 6-ジメチルフェニルスルホニルメチル基、2, 4-ジメチルフェニルスルホニルエチル基、2, 4-ジメチルフェニルスルホニルプロピル基、2, 4-ジメチルフェニルスルホニルブチル基等のアリールスルホニル基で置換されたアルキル基；

チアジアゾリノメチル基、ピロリノメチル基、ピロリジノメチル基、ピラゾリジノメチル基、イミダゾリジノメチル基、オキサゾリル基、トリアゾリノメチル基、モルホリノメチル基、インドーリノメチル基、ベンズイミダゾリノメチル基、カルバゾリノメチル基等の複素環基で置換されたアルキル基；
等が挙げられる。

【0055】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアラルキル基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアラルキル基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアラルキル基であり、具体例としては、ベンジル基、フェネチル基、 α -メチルベンジル基、 α , α -ジメチルベンジル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、フルフリル基、2-メチルベンジル基、3-メチルベンジル基、4-メチルベンジル基、4-エチルベンジル基、4-イソプロピルベンジル基、4-tert-ブチルベンジル基、4-n-ヘキシルベンジル基、4-n-ノニルベンジル基、3, 4-ジメチルベンジル基、3-メトキシベンジル基、4-メトキシベンジル基、4-エトキシベンジル基、4-n-ブチルオキシベンジル基、4-n-ヘキシルオキシベンジル基、4-n-ノニルオキシベンジル基、3-フルオロベンジル基、4-フルオロベンジル基、2-クロロベンジル基、4-クロロベンジル基等が挙げられる。

【0056】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアリール基とは、無置換の炭素環式芳香族基、複素環式芳香族基、メタロセニル基、あるいは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有する炭素環式芳香族基、複素環式芳香族基、メタロセニル基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有する炭素環式芳香族基、複素環式芳香族基、メタロセニル基であり、具体例としては、フェニル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2-エチルフェニル基、4-n-ブロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、2-イソブロピルフェニル基、4-n-ブチルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-sec-ブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、3-tert-ブチルフェニル基、2-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-イソペンチルフェニル基、4-n-ネオペンチルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチルブチル)フェニル基、4-n-ヘブチルフェニル基、4-n-オクチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキシル)フェニル基、4-n-ノニルフェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ウンデシルフェニル基、4-n-ドデシルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-(4'-メチルシクロヘキシル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチルシクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、2, 3-ジメチルフェニル基、2, 4-ジメチルフェニル基、2, 5-ジメチルフェニル基、2, 6-ジメチルフェニル基、3, 4-ジメチルフェニル基、3, 5-ジメチルフェニル基、3, 4, 5-トリメチルフェニル基、2, 3, 5, 6-テトラメチルフェニル基、2, 4-ジエチルフェニル基、2, 6-ジエチルフェニル基、2, 5-ジイソブチルフェニル基、2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル基、2, 5-ジ-tert-ブチルフェニル基、4, 6-ジ-tert-ブチル-2-メチルフェニル基、5-tert-ブチル-2-メチルフェニル基、4-tert-ブチル-2, 6-ジメチルフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-5-ナフチル基、1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-6-ナフチル基、4-エチル-1-ナフチル基、6-n-ブチル-2-ナフチル基、5-インダニル基、4-メトキシフェニル基、3-メトキシフェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニル基、4-n-ブロピルオキシフェニル基、4-イソブロピルオキシフェニル基、2-イソブロピルオキシフェニル基、4-n-ブチルオキシフェニル基、4-イソブチルオキシフェニル基、2-sec-ブチルオキシフェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基、2-イソペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-(2'-エチルブチル)オキシフェニル基、4-n-ヘブチル

ルオキシフェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n-ノニルオキシフェニル基、4-n-デシルオキシフェニル基、4-n-ウンデシルオキシフェニル基、4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2,3-ジメトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、3,4-ジメトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ジエトキシフェニル基、2-メトキシ-4-メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフェニル基、2-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル-5-メトキシフェニル基、2-メトキシ-1-ナフチル基、4-メトキシ-1-ナフチル基、4-n-ブチルオキシ-1-ナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-メトキシ-2-ナフチル基、6-エトキシ-2-ナフチル基、6-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシ-2-ナフチル基、7-メトキシ-2-ナフチル基、7-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、
 4-フェニルフェニル基、3-フェニルフェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェニル基、4-(3'-メチルフェニル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ブチルオキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフェニル)フェニル基、3-メチル-4-フェニルフェニル基、3-メトキシ-4-フェニルフェニル基、9-フェニル-2-フルオレニル基、9,9-ジフェニル-2-フルオレニル基、9-メチル-9-フェニル-2-フルオレニル基、9-エチル-9-フェニル-2-フルオレニル基、
 4-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、2,3-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフェニル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4-ジクロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,6-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,5-ジブロモフェニル基、2,4,6-トリクロロフェニル基、2-フルオロ-4-メチルフェニル基、2-フルオロ-5-メチルフェニル基、3-フルオロ-2-メチルフェニル基、3-フルオロ-4-メチルフェニル基、2-メチル-4-フルオロフェニル基、2-メチル-5-フルオロフェニル基、3-メチル-4-フルオロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、3-メチル-2-クロロ-5-メチルフェニル基、2-クロロ-6-メチルフェニル基、3-クロロ-4-メチルフェニル基、2-メチル-3-クロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニル基、3-メチル-4-クロロフェニル基、2-クロロ-4,6-ジメチルフェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチル基、1,6-ジクロロ-2-ナフチル基、2-メトキシ-4-フルオロフェニル基、3-メトキシ-4-フルオロフェニル基、2-フルオロ-4-メトキシフェニル基、2-フルオロ-4-エトキシフェニル基、2-フルオロ-6-メトキシフェニル基、3-フルオロ-4-メトキシフェニル基、3-フルオロ-4-エトキシフェニル基、2-クロロ-4-メトキシフェニル基、3-メトキシ-5-クロロフェニル基、3-メトキシ-4-クロロフェニル基、3-メトキシ-6-クロロフェニル基、5-クロロ-2,4-ジメトキシフェニル基、2-ヒドロキシフェニル基、3-ヒドロキシフェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、2-ニトロフェニル基、3-ニトロフェニル基、4-ニトロフェニル基、2-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、4-シアノフェニル基、2-メチル-5-ニトロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、2-ヒドロキシ-4-ニトロフェニル基等の置換または無置換の炭素環式芳香族基；

4-ピリジル基、3-ピリジル基、2-ピリジル基、4-メチル-2-ピリジル基、5

—メチル—2—ピリジル基、6—メチル—2—ピリジル基、4, 6—ジメチル—2—ピリジル基、4—メチル—5—ニトロ—2—ピリジル基、3—ヒドロキシ—2—ピリジル基、6—フルオロー—3—ピリジル基、6—メトキシ—3—ピリジル基、6—メトキシ—2—ピリジル基、2—ピリミジル基、4—ピリミジル基、5—ピリミジル基、2, 6—ジメチル—4—ピリミジル基、4—キノリル基、3—キノリル基、4—メチル—2—キノリル基、3—フリル基、2—フリル基、3—チエニル基、2—チエニル基、4—メチル—3—チエニル基、5—メチル—2—チエニル基、3—メチル—2—チエニル基、2—オキサゾリル基、2—チアゾリル基、2—チアジアゾリル基、2—ベンゾオキサゾリル基、2—ベンゾチアゾリル基、2—ベンゾイミダゾリル基等の置換または無置換の複素環式芳香族基；

フェロセニル基、コバルトセニル基、ニッケロセニル基、ジクロロチタノセニル基、トリクロロチタンシクロペンタジエニル基、ビス（トリフルオメタンスルホナト）チタノセニル基、ジクロロジルコノセニル基、ジメチルジルコノセニル基、ジエトキシジルコノセニル基、ビス（シクロペンタジエニル）クロム基、ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロモリブデン基、ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロハフニウム基、ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロニオブ基、ビス（シクロペンタジエニル）ルテニウム基、ビス（シクロペンタジエニル）バナジウム基、ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロバナジウム基、オクタメチルフェロセニル基、オクタメチルコバルトセニル基、オクタメチルニッケロセニル基等の置換または無置換のメタロセニル基；

等が挙げられる。

【0057】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアルコキシ基とは、前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアルコキシ基であり、具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n—プロピルオキシ基、イソプロピルオキシ基、n—ブチルオキシ基、イソブチルオキシ基、tert—ブチルオキシ基、sec—ブチルオキシ基、n—ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、tert—ペンチルオキシ基、sec—ペンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、n—ヘキシルオキシ基、1—メチルペンチルオキシ基、2—メチルペンチルオキシ基、3—メチルペンチルオキシ基、4—メチルペンチルオキシ基、1, 1—ジメチルブチルオキシ基、1, 2—ジメチルブチルオキシ基、1, 3—ジメチルブチルオキシ基、2, 3—ジメチルブチルオキシ基、1, 1, 2—トリメチルプロピルオキシ基、1, 2, 2—トリメチルプロピルオキシ基、1—エチルブチルオキシ基、2—エチルブチルオキシ基、1—エチル—2—メチルプロピルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、メチルシクロペンチルオキシ基、n—ヘプチルオキシ基、1—メチルヘキシルオキシ基、2—メチルヘキシルオキシ基、3—メチルヘキシルオキシ基、4—メチルヘキシルオキシ基、5—メチルヘキシルオキシ基、1, 1—ジメチルペンチルオキシ基、1, 2—ジメチルペンチルオキシ基、1, 3—ジメチルペンチルオキシ基、1, 4—ジメチルペンチルオキシ基、2, 2—ジメチルペンチルオキシ基、2, 3—ジメチルペンチルオキシ基、2, 4—ジメチルペンチルオキシ基、3, 3—ジメチルペンチルオキシ基、3, 4—ジメチルペンチルオキシ基、1—エチルペンチルオキシ基、2—エチルペンチルオキシ基、3—エチルペンチルオキシ基、1, 1, 2—トリメチルブチルオキシ基、1, 1, 3—トリメチルブチルオキシ基、1, 2, 3—トリメチルブチルオキシ基、1, 2—トリメチルブチルオキシ基、1, 3, 3—トリメチルブチルオキシ基、2, 3, 3—トリメチルブチルオキシ基、1—エチル—1—メチルブチルオキシ基、1—エチル—2—メチルブチルオキシ基、1—エチル—3—メチルブチルオキシ基、2—エチル—1—メチルブチルオキシ基、2—エチル—3—メチルブチルオキシ基、1—n—プロピルブチルオキシ基、1—イソプロピルブチルオキシ基、1—イソプロピル—2—メチルプロピルオキシ基、メチルシクロヘキシルオキシ基、n—オクチルオキシ基、1—メチルヘプチルオキシ基、2—メチルヘプチルオキシ基、3—メチルヘプチルオキシ基、4—メチルヘプチルオキシ基、5—メチルヘプチルオキシ基、6—メチルヘプチルオキシ基、1, 1—ジメチルヘキシルオキシ基、1, 2—ジメチルヘキシルオキシ基、1, 3—ジメチルヘキシルオキシ基、1, 4—ジメチルヘキシルオキシ基、1, 5—ジメチルヘキシル

オキシ基、2, 2-ジメチルヘキシルオキシ基、2, 3-ジメチルヘキシルオキシ基、2, 4-ジメチルヘキシルオキシ基、2; 5-ジメチルヘキシルオキシ基、3, 3-ジメチルヘキシルオキシ基、3, 4-ジメチルヘキシルオキシ基、3, 5-ジメチルヘキシルオキシ基、4, 4-ジメチルヘキシルオキシ基、4, 5-ジメチルヘキシルオキシ基、1-エチルヘキシルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、3-エチルヘキシルオキシ基、4-エチルヘキシルオキシ基、1-n-プロピルペンチルオキシ基、2-n-プロピルペンチルオキシ基、1-イソプロピルペンチルオキシ基、2-イソプロピルペンチルオキシ基、1-エチル-1-メチルペンチルオキシ基、1-エチル-2-メチルペンチルオキシ基、1-エチル-3-メチルペンチルオキシ基、1-エチル-4-メチルペンチルオキシ基、2-エチル-1-メチルペンチルオキシ基、2-エチル-2-メチルペンチルオキシ基、2-エチル-3-メチルペンチルオキシ基、2-エチル-4-メチルペンチルオキシ基、3-エチル-1-メチルペンチルオキシ基、3-エチル-2-メチルペンチルオキシ基、3-エチル-3-メチルペンチルオキシ基、3-エチル-4-メチルペンチルオキシ基、1, 1, 2-トリメチルペンチルオキシ基、1, 1, 3-トリメチルペンチルオキシ基、1, 1, 4-トリメチルペンチルオキシ基、1, 2, 2-トリメチルペンチルオキシ基、1, 2, 3-トリメチルペンチルオキシ基、1, 2, 4-トリメチルペンチルオキシ基、1, 3, 4-トリメチルペンチルオキシ基、2, 2, 3-トリメチルペンチルオキシ基、2, 2, 4-トリメチルペンチルオキシ基、2, 3, 4-トリメチルペンチルオキシ基、1, 3, 3-トリメチルペンチルオキシ基、2, 3, 3-トリメチルペンチルオキシ基、3, 3, 4-トリメチルペンチルオキシ基、1, 4, 4-トリメチルペンチルオキシ基、2, 4, 4-トリメチルペンチルオキシ基、3, 4, 4-トリメチルペンチルオキシ基、1-n-ブチルブチルオキシ基、1-イソブチルブチルオキシ基、1-sec-ブチルブチルオキシ基、1-tert-ブチルブチルオキシ基、2-tert-ブチルブチルオキシ基、1-n-プロピル-1-メチルブチルオキシ基、1-n-プロピル-2-メチルブチルオキシ基、1-n-プロピル-3-メチルブチルオキシ基、1-イソプロピル-1-メチルブチルオキシ基、1-イソプロピル-2-メチルブチルオキシ基、1-イソプロピル-3-メチルブチルオキシ基、1, 1-ジエチルブチルオキシ基、1, 2-ジエチルブチルオキシ基、1-エチル-1, 2-ジメチルブチルオキシ基、1-エチル-1, 3-ジメチルブチルオキシ基、1-エチル-2, 3-ジメチルブチルオキシ基、2-エチル-1, 1-ジメチルブチルオキシ基、2-エチル-1, 2-ジメチルブチルオキシ基、2-エチル-2, 3-ジメチルブチルオキシ基、1, 1, 3-ジメチルブチルオキシ基、1, 2-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、1, 3-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、1, 4-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、エチルシクロヘキシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシ基、n-デシルオキシ基、n-ウンデシルオキシ基、n-ドデシルオキシ基、1-アダマンチルオキシ基、n-ペンタデシルオキシ基等の直鎖、分岐又は環状の無置換アルコキシ基；

メトキシメトキシ基、メトキシエトキシ基、エトキシエトキシ基、n-プロピルオキシエトキシ基、イソプロピルオキシエトキシ基、n-ブチルオキシエトキシ基、イソブチルオキシエトキシ基、tert-ブチルオキシエトキシ基、sec-ブチルオキシエトキシ基、n-ペンチルオキシエトキシ基、イソペンチルオキシエトキシ基、tert-ペンチルオキシエトキシ基、sec-ペンチルオキシエトキシ基、シクロペンチルオキシエトキシ基、n-ヘキシルオキシエトキシ基、エチルシクロヘキシルオキシエトキシ基、n-ノニルオキシエトキシ基、(3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシ)エトキシ基、(3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシ)ブチルオキシ基、n-デシルオキシエトキシ基、n-ウンデシルオキシ基、n-ドデシルオキシエトキシ基、3-メトキシプロピルオキシ基、3-エトキシプロピルオキシ基、3-(n-プロピルオキシ)プロピルオキシ基、2-イソプロピルオキシプロピルオキシ基、2-メトキシブチルオキシ基、2-エトキシブチルオキシ基、2-(n-プロピルオキシ)ブチルオキシ基、4-イソプロピルオキシブチルオキシ基、デカリルオキシエトキシ基、アダマンチルオキシエトキシ基等のアルコキシ基で

置換されたアルコキシ基；

メトキシカルボニルメトキシ基、エトキシカルボニルメトキシ基、n-プロピルオキシカルボニルメトキシ基、イソプロピルオキシカルボニルメトキシ基、(4' -エチルシクロヘキシリオキシ)カルボニルメトキシ基等のアルコキシカルボニル基で置換されたアルコキシ基；

アセチルメトキシ基、エチルカルボニルメトキシ基、n-オクチルカルボニルメトキシ基、フェナシルオキシ基等のアシル基で置換されたアルコキシ基；

アセチルオキシメトキシ基、アセチルオキシエトキシ基、アセチルオキシヘキシルオキシ基、n-ブタノイルオキシシクロヘキシルオキシ基等のアシルオキシ基で置換されたアルコキシ基；

メチルアミノメトキシ基、2-メチルアミノエトキシ基、2-(2-メチルアミノエトキシ)エトキシ基、4-メチルアミノブチルオキシ基、1-メチルアミノプロパン-2-イルオキシ基、3-メチルアミノプロピルオキシ基、2-メチルアミノ-2-メチルプロピルオキシ基、2-エチルアミノエトキシ基、2-(2-エチルアミノエトキシ)エトキシ基、3-エチルアミノプロピルオキシ基、1-エチルアミノプロピルオキシ基、2-イソプロピルアミノエトキシ基、2-(n-ブチルアミノ)エトキシ基、3-(n-ヘキシルアミノ)プロピルオキシ基、4-(シクロヘキシルアミノ)ブチルオキシ基等のアルキルアミノ基で置換されたアルコキシ基；

メチルアミノメトキシメトキシ基、メチルアミノエトキシエトキシ基、メチルアミノエトキシプロピルオキシ基、エチルアミノエトキシプロピルオキシ基、4-(2'-イソブチルアミノプロピルオキシ)ブチルオキシ基等のアルキルアミノアルコキシ基で置換されたアルコキシ基；

ジメチルアミノメトキシ基、2-ジメチルアミノエトキシ基、2-(2-ジメチルアミノエトキシ)エトキシ基、4-ジメチルアミノブチルオキシ基、1-ジメチルアミノプロパン-2-イルオキシ基、3-ジメチルアミノプロピルオキシ基、2-ジメチルアミノ-2-メチルプロピルオキシ基、2-ジエチルアミノエトキシ基、2-(2-ジエチルアミノエトキシ)エトキシ基、3-ジエチルアミノプロピルオキシ基、1-ジエチルアミノプロピルオキシ基、2-ジイソプロピルアミノエトキシ基、2-(ジ-n-ブチルアミノ)エトキシ基、2-ビペリジルエトキシ基、3-(ジ-n-ヘキシルアミノ)プロピルオキシ基等のジアルキルアミノ基で置換されたアルコキシ基；

ジメチルアミノメトキシメトキシ基、ジメチルアミノエトキシプロピルオキシ基、ジエチルアミノエトキシプロピルオキシ基、4-(2'-ジイソブチルアミノプロピルオキシ)ブチルオキシ基等のジアルキルアミノアルコキシ基で置換されたアルコキシ基；

メチルチオメトキシ基、2-メチルチオエトキシ基、2-エチルチオエトキシ基、2-n-プロピルチオエトキシ基、2-イソプロピルチオエトキシ基、2-n-ブチルチオエトキシ基、2-イソブチルチオエトキシ基、(3, 5, 5-トリメチルヘキシルチオ)ヘキシルオキシ基等のアルキルチオ基で置換されたアルコキシ基；

等が挙げられる。

【0058】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアラルキルオキシ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアラルキルオキシ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアラルキルオキシ基であり、具体例としては、ベンジルオキシ基、4-ニトロベンジルオキシ基、4-シアノベンジルオキシ基、4-ヒドロキシベンジルオキシ基、2-メチルベンジルオキシ基、3-メチルベンジルオキシ基、4-メチルベンジルオキシ基、4-トリフルオロメチルベンジルオキシ基、1-ナフチルメトキシ基、2-ナフチルメトキシ基、4-シアノ-1-ナフチルメトキシ基、4-ヒドロキシ-1-ナフチルメトキシ基、6-ヒドロキシ-2-ナフチルメトキシ基、4-メチル-1-ナフチルメトキシ基、6-メチル-2-ナフチルメトキシ基、4-トリフルオロメチル-1-ナフチルメトキシ基、フルオレン-9-イルエトキシ基等が挙げられる。

【0059】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアリールオキシ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアリールオキシ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアリールオキシ基であり、具体例としては、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、4-tert-ブチルフェノキシ基、2-メトキシフェノキシ基、4-イソプロピルフェノキシ基、ナフチルオキシ基、フェロセニルオキシ基、コバルトセニルオキシ基、ニッケロセニルオキシ基、オクタメチルフェロセニルオキシ基、オクタメチルコバルトセニルオキシ基、オクタメチルニッケロセニルオキシ基等が挙げられる。

【0060】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアルキルチオ基とは、前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアルキルチオ基であり、具体例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、n-ブロピルチオ基、インプロピルチオ基、n-ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、2-メチルブチルチオ基、メチルカルボキシルエチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、3, 5, 5-トリメチルヘキシルチオ基、デカリルチオ基等が挙げられる。

【0061】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアラルキルチオ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアラルキルチオ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアラルキルチオ基であり、具体例としては、ベンジルチオ基、4-シアノベンジルチオ基、4-ヒドロキシベンジルチオ基、2-メチルベンジルチオ基、3-メチルベンジルチオ基、4-メチルベンジルチオ基、4-トリフルオロメチルベンジルチオ基、1-ナフチルメチルチオ基、4-ニトロ-1-ナフチルメチルチオ基、4-シアノ-1-ナフチルメチルチオ基、4-ヒドロキシ-1-ナフチルメチルチオ基、4-メチル-1-ナフチルメチルチオ基、4-トリフォロオメチル-1-ナフチルメチルチオ基、フルオレン-9-イルエチルチオ基等が挙げられる。

【0062】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアリールチオ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアリールチオ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアリールチオ基であり、具体例としては、フェニルチオ基、4-メチルフェニルチオ基、2-メトキシフェニルチオ基、4-tert-ブチルフェニルチオ基、ナフチルチオ基、フェロセニルチオ基、コバルトセニルチオ基、ニッケロセニルチオ基、オクタメチルフェロセニルチオ基、オクタメチルコバルトセニルチオ基、オクタメチルニッケロセニルチオ基等が挙げられる。

【0063】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアシル基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアシル基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアシル基であり、具体例としては、ホルミル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、n-ブロピルカルボニル基、イソブロピルカルボニル基、n-ブチルカルボニル基、イソブチルカルボニル基、sec-ブチルカルボニル基、tert-ブチルカルボニル基、n-ペンチルカルボニル基、イソペンチルカルボニル基、ネオペンチルカルボニル基、2-メチルブチルカルボニル基、ベンゾイル基、2-メチルベンゾイル基、3-メチルベンゾイル基、4-メチルベンゾイル基、4-エチルベンゾイル基、4-n-ブロピルベンゾイル基、4-tert-ブチルベンゾイル基、4-ニトロベンジルカルボニル基、3-n-ブトキシ-2-ナフトイル基、シンナモイル基等が挙げられる。

【0064】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアシルオキシ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアシルオキシ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアシルオキシ基であり、具体例としては、ホルミロキシ基、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、n-ブロピルカルボニルオキシ基、イソブロピルカルボニルオキシ基、n-ブチルカルボニルオキシ基、イソブチルカルボニルオキシ基、sec-ブチルカルボニルオキシ基、tert-ブチルカルボニルオキシ基、n-ペンチルカルボニルオキシ基、イソペンチルカルボニルオキシ基、ネオペンチルカルボニルオキシ基、2-メチルブチルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、2-メチルベンゾイルオキシ基、3-メチルベンゾイルオキシ基、4-メチルベンゾイルオキシ基、4-エチルベンゾイルオキシ基、4-n-ブロピルベンゾイルオキシ基、4-tert-ブチルベンゾイルオキシ基、4-ニトロベンジルカルボニルオキシ基、3-n-ブトキシ-2-ナフトイルオキシ基、シンナモイルオキシ基等が挙げられる。

【0065】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアルコキシカルボニル基とは、前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアルコキシカルボニル基であり、具体例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-ブロピルオキシカルボニル基、イソブロピルオキシカルボニル基、n-ブチ

ルオキシカルボニル基、イソブチルオキシカルボニル基、sec-ブチルオキシカルボニル基、tert-ブチルオキシカルボニル基、n-ペンチルオキシカルボニル基、イソペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシルオキシカルボニル基、3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシカルボニル基、デカリルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、2-クロロエトキシカルボニル基、ヒドロキシメトキシカルボニル基、2-ヒドロキシエトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基；

メトキシメトキシカルボニル基、メトキシエトキシカルボニル基、エトキシエトキシカルボニル基、n-プロピルオキシエトキシカルボニル基、n-ブチルオキシエトキシカルボニル基、n-ペンチルオキシエトキシカルボニル基、n-ヘキシルオキシエトキシカル基、n-ブチルオキシブチルオキシカルボニル基、n-ヘキシルオキシブチルオキシカルボニル基、ヒドロキシメトキシメトキシカルボニル基、ヒドロキシエトキシカルボニル基等のアルコキシ基で置換されたアルコキシカルボニル基；

メトキシメトキシメトキシカルボニル基、メトキシエトキシエトキシカルボニル基、エトキシエトキシエトキシカルボニル基、n-プロピルオキシエトキシカルボニル基、n-ブチルオキシエトキシカルボニル基、n-ペンチルオキシエトキシカルボニル基等のアルコキシアルコキシ基で置換されたアルコキシカルボニル基；

等が挙げられる。

【0066】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアラルキルオキシカルボニル基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアラルキルオキシカルボニル基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアラルキルオキシカルボニル基であり、具体例としては、ベンジルオキシカルボニル基、4-ニトロベンジルオキシカルボニル基、4-シアノベンジルオキシカルボニル基、4-ヒドロキシベンジルオキシカルボニル基、2-メチルベンジルオキシカルボニル基、3-メチルベンジルオキシカルボニル基、4-メチルベンジルオキシカルボニル基、4-トリフルオロメチルベンジルオキシカルボニル基、1-ナフチルメトキシカルボニル基、2-ナフチルメトキシカルボニル基、4-シアノ-1-ナフチルメトキシカルボニル基、4-ヒドロキシ-1-ナフチルメトキシカルボニル基、6-ヒドロキシ-2-ナフチルメトキシカルボニル基、4-メチル-1-ナフチルメトキシカルボニル基、6-メチル-2-ナフチルメトキシカルボニル基、4-トリフルオロメチル-1-ナフチルメトキシカルボニル基、フルオレン-9-イルエトキシカルボニル基等が挙げられる。

【0067】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアリールオキシカルボニル基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアリールオキシカルボニル基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアリールオキシカルボニル基であり、具体例としては、フェニルオキシカルボニル基、2-メチルフェニルオキシカルボニル基、4-メチルフェニルオキシカルボニル基、4-tert-ブチルフェニルオキシカルボニル基、2-メトキシフェニルオキシカルボニル基、4-イソプロピルフェニルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等が挙げられる。

【0068】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、置換または無置換のアミノ基とは、前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアミノ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアルキルアミノ基であり、具体例としては、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、ブチルアミノ基、ベンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、3, 5, 5-トリメチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基等のモノアルキルアミノ基やジメチルアミノ基

、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、ジ(アセチルオキシエチル)アミノ基、ジ(プロピオニルオキシエチル)アミノ基等のジアルキルアミノ基；

前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアラルキルアミノ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアラルキルアミノ基であり、具体例としては、ベンジルアミノ基、フェネチルアミノ基、3-フェニルプロピルアミノ基、4-エチルベンジルアミノ基、4-イソプロピルベンジルアミノ基等のモノアラルキルアミノ基や、ジベンジルアミノ基、ジフェネチルアミノ基、ビス(4-エチルベンジル)アミノ基、ビス(4-イソプロピルベンジル)アミノ基等のジアラルキルアミノ基；

前記に挙げたアルキル基を置換基として有してもよいアリールアミノ基、または前記に挙げたアルキル基が有する置換基と同様な置換基を有してもよいアリールアミノ基であり、具体例としては、フェニルアミノ基、1-ナフチルアミノ基、2-ナフチルアミノ基、2-メチルフェニルアミノ基、3-メチルフェニルアミノ基、4-メチルフェニルアミノ基、2,4-ジメチルフェニルアミノ基、2,6-ジメチルフェニルアミノ基、4-エチルフェニルアミノ基、4-イソプロピルフェニルアミノ基、4-メトキシフェニルアミノ基、4-クロロフェニルアミノ基、4-アセチルフェニルアミノ基、4-メトキシカルボニルフェニルアミノ基、4-エトキシカルボニルフェニルアミノ基、4-プロピルオキシカルボニルフェニルアミノ基等のモノアリールアミノ基や、N,N-ジフェニルアミノ基、N,N-ジ(3-メチルフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-メチルフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-エチルフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-n-ヘキシルフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-メトキシフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-n-ブチルオキシフェニル)アミノ基、N,N-ジ(4-n-ヘキシルオキシフェニル)アミノ基、N,N-ジ(1-ナフチル)アミノ基、N,N-ジ(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(3-メチルフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-メチルフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-n-オクチルフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-メトキシフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-n-ヘキシルオキシフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-フルオロフェニル)アミノ基、N-フェニル-N-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(4-フェニルフェニル)アミノ基等のジアリールアミノ基；

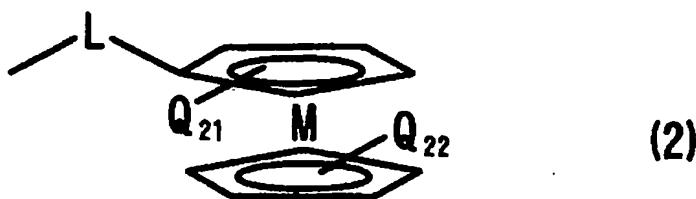
等が挙げられる。

【0069】

環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、メタロセニル残基を有する基とは、連結基および置換または無置換のメタロセニル基からなる基であり、好ましくは、下記一般式(2)で表される基である。

【0070】

【化2】



【0071】

(式中、Lは連結基を表し、Q₂₁、Q₂₂はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、炭素数1~4のアミノアル

キル基またはジアリールホスフィノ基を表し、Mは二価の遷移金属を表す。)

【0072】

一般式(2)で表される基において、Q_{2,1}およびQ_{2,2}は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4のアルキル基、炭素数1～4のアルコキシ基、炭素数1～4のアミノアルキル基またはジアリールホスフィノ基を表し、Q_{2,1}およびQ_{2,2}の具体例としては、水素原子、

フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、

メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等のアルキル基、

メトキシ基、エトキシ基、n-プロピルオキシ基、イソプロピルオキシ基、n-ブチルオキシ基、イソブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、tert-ブチルオキシ基等のアルコキシ基、

アミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基、アミノブチル基等のアミノアルキル基、

ジフェニルホスフィノ基、フェニル-3,5-キシリルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基、

等が挙げられる。

【0073】

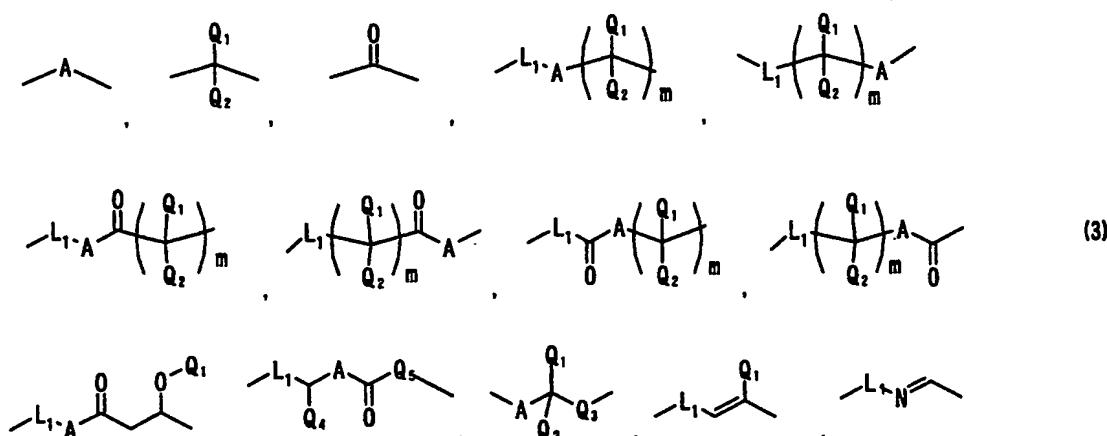
一般式(2)で表される基において、Mは二価の遷移金属を表し、具体例としては、Fe、Co、Ni、Ru、Os、Mn、Cr、W、V、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Er、Tm、Yb等が挙げられ、特に好ましくは、Feである。

【0074】

一般式(2)で表される基において、Lは連結基を表し、好ましくは、下記式(3)のいずれかで表される基である。

【0075】

【化3】



【0076】

[式中、Aは-O-、-S-、-N(Q₆)ーのいずれかで表される基を表し、L₁は単結合、置換または無置換の二価の脂肪族炭化水素基あるいは置換または無置換の二価の芳香族環基を表し、Q₁、Q₂、Q₆はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数1～4のアルキル基を表し、Q₃は-O-Q₇-、-C(=O)-O-Q₇-、-O-C(=O)-Q₇-のいずれかで表される基を表し、Q₇は単結合、炭素数1～4のアルキレン基、炭素数2～4のアルケニレン基のいずれかを表し、Q₄は水素原子またはメチル基を表し、Q₅は-CH₂-、-CH₂CH₂-、-CH=CH-、-CH₂-C(=O)-、-CH₂CH₂C(=O)-のいずれかで表される基を表し、mは0～4の整数である。]

【0077】

上式中、L₁は単結合、置換または無置換の二価の脂肪族炭化水素基あるいは置換また

は無置換の二価の芳香族環基を表し、具体例としては、単結合、

メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、シクロヘキセン基、ヘキサメチレン基、シクロヘキシレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、ノナメチレン基、デカメチレン基、ウンデカメチレン基、ドデカメチレン基、トリデカメチレン基、テトラデカメチレン基、ペンタデカメチレン基等のアルキレン基

、ビニレン基、プロペニレン基、1-ブテニレン基、1-ペニテニレン基、2-ペニテニレン基、デカニレン基等のアルケニレン基等の脂肪族炭化水素基；

フェニレン基、ナフチレン基、インデニレン基、アントラセニレン基、フルオレニレン基、アズレニレン基、ナフタセニレン基、クリセニレン基、ピレニレン基、ペリレニレン基等の芳香族炭化水素基；

フラニレン基、ピロリレン基、3-ピロリニレン基、ピロリジニレン基、1, 3-オキソラニレン基、ピラゾリレン基、2-ピラゾリニレン基、ピラゾリジニレン基、イミダゾリレン基、オキサゾリレン基、チアゾリレン基、1, 2, 3-オキサジアゾリレン基、1, 2, 3-トリアゾリレン基、1, 2, 4-トリアゾリレン基、1, 3, 4-チアジアゾリレン基、4H-ピラニレン基、ピリジニレン基、ピペリジニレン基、ジオキサンニレン基、モルホリニレン基、ピリダジニレン基、ピリミジニレン基、ピラジニレン基、ピペラジニレン基、トリアジニレン基、ベンゾフラニレン基、インドリレン基、チオナフセニレン基、ベンズイミダゾリレン基、ベンゾチアゾリレン基、ブリニレン基、キノリニレン基、イソキノリレン基、クマリニレン基、シンノリニレン基、キノキサリニレン基、ジベンゾフラニレン基、カルバゾリレン基、フェナントロニリレン基、フェノチアジニレン基、フラボニレン基、ペリミジレン基等の複素環基；

等が挙げられる。

【0078】

Q_1 、 Q_2 、 Q_6 の具体例としては、水素原子、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基が挙げられる。

Q_7 の具体例としては、上記に挙げたのと同様な炭素数1～4のアルキレン基、ビニレン基、プロピレニレン基、1-ブテニレン基等の炭素数2～4のアルケニレン基が挙げられる。

【0079】

一般式(1)で表される化合物において、環Aおよび環Bが置換基を有する場合の置換基の、互いに隣接する基は連結基を介して、置換している炭素原子と共に環構造を形成してもよく、その際の連結基としては、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子および炭素原子を適宜組み合わせてなる基であり、好ましい連結基の例としては、-O-、-S-または置換されていてもよいメチレン基、メチン基、エチニレン基、フェニレン基、アミノ基、イミノ基、等が挙げられ、適宜組み合わせて所望する環構造を形成することができる。

【0080】

一般式(1)で表される化合物において、Rはそれぞれ独立に、水素原子または置換基を表す。

【0081】

Rで表される置換基とは、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換または無置換のアルキル基、置換または無置換のアラルキル基、置換または無置換のアリール基、置換または無置換のアルコキシ基、置換または無置換のアラルキルオキシ基、置換または無置換のアリールオキシ基、置換または無置換のアルキルチオ基、置換または無置換のアラルキルチオ基、置換または無置換のアリールチオ基、置換または無置換のアシル基、置換または無置換のアシルオキシ基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基、置換または無置換のアラルキルオキシカルボニル基、置換または無置換のアリールオキシカルボニル基、置換または無置換のアミノ基、あるいはメタロセニル

残基を有する基を指し、それぞれの置換基の具体的な例としては、前述の環Aおよび環Bに置換する置換基の具体例と同様な置換基が挙げられる。

【0082】

一般式(1)で表される化合物において、Xは酸素原子または硫黄原子を表す。

【0083】

一般式(1)で表される化合物において、Yは連結基を表し、好ましくは、前述の式(3)で表される基である。Yは、環A、環BあるいはRに直接結合していてもよく、環Aおよび環Bが置換基を有する場合には、置換基に結合していてもよい。

【0084】

一般式(1)で表される化合物において、Zは、ヘテロ原子を少なくとも1個含有する環状の置換アルキル基が置換した置換アルキル基を指す。ここで、「ヘテロ原子を含有する」とは、单一または複数の炭素原子—炭素原子間、および／または炭素原子—水素原子間に1つ以上の同一あるいは異なるヘテロ原子を有することを指す。

【0085】

なお、ここでいうヘテロ原子とは、炭素原子以外の原子を指し、好ましくは酸素原子、硫黄原子、窒素原子が挙げられる。

【0086】

また、ここでいう「置換アルキル基」とは、前述の環A及び環Bに置換する置換アルキル基が挙げられ、その具体的な例としては、前述の環Aおよび環Bに置換する置換基の具体例と同様な置換基が挙げられる。

【0087】

Zで表されるヘテロ原子を少なくとも1個含有する環状の置換アルキル基が置換した置換アルキル基としては、好ましくはヘテロ原子を少なくとも2個含有する環状の置換アルキル基が置換した置換アルキル基、より好ましくは酸素原子、硫黄原子または窒素原子から選ばれるヘテロ原子を少なくとも2個含有する環状の置換アルキル基が置換した置換アルキル基が挙げられ、さらに好ましい例としては、酸素原子、硫黄原子または窒素原子から選ばれるヘテロ原子を少なくとも2個含有する環状の脂環式ヘテロ環基が置換した置換アルキル基が挙げられる。また、ここでZにおいて規定する「置換アルキル基」としては、炭素数3～20の置換アルキル基が好ましい。

【0088】

ヘテロ原子を少なくとも2個含有する環状の脂環式ヘテロ環基の好適な例としては、置換または無置換の1,2-ジオキソラニル基、1,3-ジオキソラニル基、1,2-ジオキサニル基、1,3-ジオキサニル基、1,4-ジオキサニル基、1,3,5-トリオキサニル基等の含酸素ヘテロ環基；

置換または無置換のオキサゾリジニル基、1,3-オキサジナニル基、モルホリニル基等の含酸素含窒素ヘテロ環基；
置換または無置換の2-メチルピペラジノ基、2-エチルピペラジノ基、2-プロピルピペラジノ基、2-ブチルピペラジノ基、3-メチルピペラジノ基、3-エチルピペラジノ基、3-ブロピルピペラジノ基、3-ブチルピペラジノ基、4-メチルピペラジノ基、4-エチルピペラジノ基、4-ブロピルピペラジノ基、4-ブチルピペラジノ基等の含窒素ヘテロ環基；

等の脂環式ヘテロ環基が挙げられる。

【0089】

一般式(1)で表される化合物において、nは1以上の整数を表し、好ましくは、1～8であり、より好ましくは、1～4である。

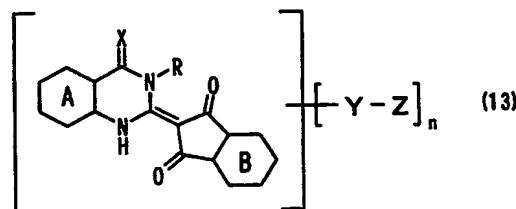
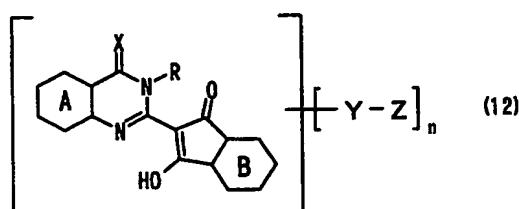
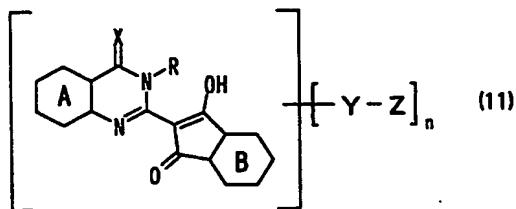
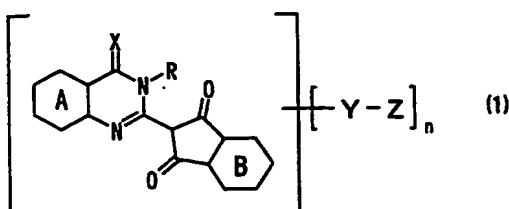
【0090】

本発明における一般式(1)で表される化合物は、互変可能な構造を有しており、互変異性体を有することが可能である。具体的には、下記一般式(1)および一般式(11)～(13)に示される構造であり、本発明では、便宜上一般式(1)の構造を示しているが、一般式(1)および一般式(11)～(13)の構造を有する化合物であってもよく

、一般式(1)および一般式(11)～(13)の各構造の混合物であっても一向に構わず、自由に用いることができる。

【0091】

【化4】

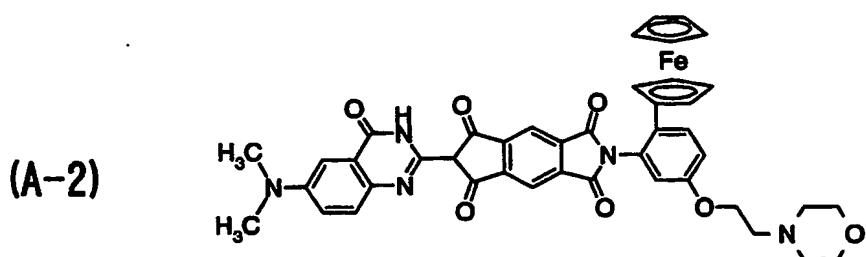
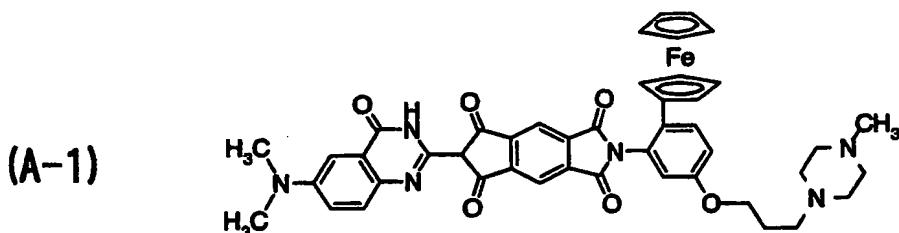


【0092】

本発明の光記録媒体に用いられる一般式(1)の具体例としては、例えば、以下の化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0093】

【表1】

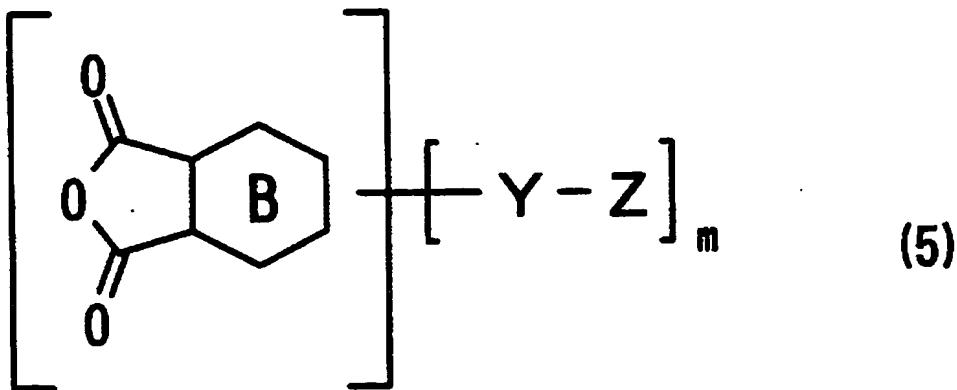
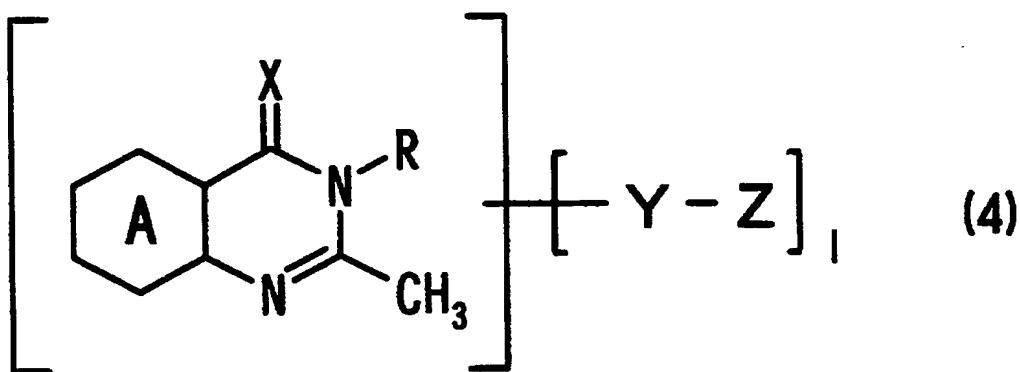


【0094】

本発明の光記録媒体に用いられるキナゾリン化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、下記一般式(4)で表される化合物と、下記一般式(5)で表される化合物とを、溶媒の存在／あるいは非存在下で加熱反応することにより、一般式(1)で表される化合物を製造することができる。また、反応の際、必要に応じて触媒を用いることもできる。

【0095】

【化5】



【0096】

[上式中、環A、環B、R、X、Y、およびZは一般式(1)の場合と同じ意味を表し、
1およびmは0または1以上の整数を表し、1+mは1以上の整数を表す。]

【0097】

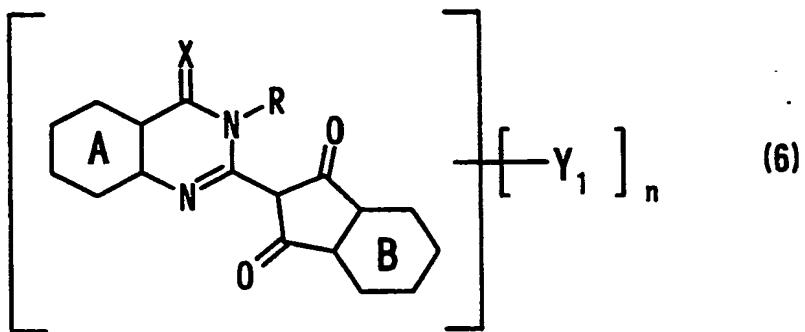
加熱反応の際に使用する溶媒としては、スルホラン等の含硫溶媒、N-メチル-2-ピロリジノン、1, 3-ジメチルイミダゾリジン-2-オン等のアミド系溶媒、1-クロロナフタレン、1, 2-ジクロロベンゼン等のハロゲン化芳香族溶媒、ニトロベンゼン等のニトロ化芳香族溶媒等が挙げられる。また、触媒としては、イソキノリン、1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウンデセン、1, 5-ジアザビシクロ[4. 3. 0]-5-ノネン等のアミン化合物が挙げられる。

【0098】

また、一般式(1)で表される化合物は、下記一般式(6)で表される化合物と下記一般式(7)で表される化合物とを反応させることにより製造することができる。

【0099】

【化6】



【0100】

[上式中、環A、環B、R、XおよびZは一般式（1）の場合と同じ意味を表し、Y₁は式（7）のY₂と反応することにより連結基Yを形成しうる官能基を有する基を表し、Y₂は官能基を表し、Yは一般式（1）の場合と同じ意味を表す。]

一般式（6）において、Y₁は式（7）のY₂と反応することにより連結基Yを形成しうる官能基を有する基を表し、官能基としては、水酸基、カルボキシル基、ホルミル基、メルカプト基、アミノ基、ハロゲン原子等が挙げられる。

【0101】

一般式（7）において、Y₂は官能基を表し、具体例としては、水酸基、カルボキシル基、ホルミル基、メルカプト基、アミノ基、ハロゲン原子等が挙げられる。

【0102】

一般式（6）で表される化合物と一般式（7）で表される化合物との反応としては、特に限定するものではないが、エーテル化、エステル化、アミノ化、イミノ化、アミド化、イミド化、チオエーテル化、チオエステル化等の反応が挙げられる。

【0103】

記録層（A）の膜厚は、10 nm～1000 nmであるが、好ましくは20 nm～300 nmである。記録層（A）の膜厚を10 nmより薄くすると、熱拡散が大きいため記録できないか、記録信号に歪が発生する上、信号振幅が小さくなる場合がある。また、膜厚が1000 nmより厚い場合は反射率が低下し、再生信号特性が悪化する場合がある。

【0104】

次に記録層（A）の上に、好ましくは50 nm～300 nmの厚さの反射層を形成する。反射率を高めるためや密着性をよくするために、記録層（A）と反射層の間に反射増幅層や接着層を設けることができる。反射層の材料としては、再生光の波長で反射率の十分高いもの、例えば、Au、Al、Ag、Cu、Ti、Cr、Ni、Pt、TaおよびPdの金属を単独あるいは合金にして用いることが可能である。この中でもAu、Ag、Alは反射率が高く反射層の材料として適している。青色レーザーでの記録再生を行う場合には、AlまたはAgが好適である。これ以外でも下記のものを含んでいても良い。例えば、Mg、Se、Hf、V、Nb、Ru、W、Mn、Re、Fe、Co、Rh、Ir、Zn、Cd、Ga、In、Si、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biの金属および半金属を挙げることができる。また、AgまたはAlを主成分とするものは反射率の高い反射層が容易に得られるため好適である。金属以外の材料で低屈折率薄膜と高屈折率薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射層として用いることも可能である。

【0105】

反射層を形成する方法としては、スパッタ法、イオンプレーティング法、化学蒸着法、

真空蒸着法等が挙げられる。また、基板の上や反射層の下に反射率の向上、記録特性の改善、再生光安定性の改善、密着性の向上等のために公知の無機系または有機系の中間層、接着層を設けることもできる。

【0106】

さらに、反射層の上に形成する保護層の材料としては反射層を外力から保護するものであれば特に限定しない。無機物質としては、 SiO_2 、 Si_3N_4 、 MgF_2 、 AlN 、 SnO_2 、 TiO_2 等が挙げられる。また、有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂等を挙げることができる。熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等は適当な溶媒に溶解して塗布液を調製した後に、この塗布液を塗布し、乾燥することによって形成することができる。紫外線硬化性樹脂はそのままもしくは適当な溶媒に溶解して塗布液を調製した後に、この塗布液を塗布し、紫外線を照射して硬化させることによって形成することができる。紫外線硬化性樹脂としては、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート等のアクリレート樹脂を用いることができる。これらの材料は単独であるいは混合して用いても良く、1層だけでなく多層膜にして用いても良い。

【0107】

保護層の形成の方法としては、記録層と同様にスピンドル法やキャスト法等の塗布法やスパッタ法や化学蒸着法等の方法が用いられるが、この中でもスピンドル法が好ましい。

【0108】

保護層の膜厚は、一般には $0.1\text{ }\mu\text{m} \sim 100\text{ }\mu\text{m}$ の範囲であるが、本発明においては $3\text{ }\mu\text{m} \sim 30\text{ }\mu\text{m}$ であり、より好ましくは、 $5\text{ }\mu\text{m} \sim 20\text{ }\mu\text{m}$ である。

【0109】

保護層の上にさらにラベル、バーコード等の印刷を行うこともできる。

【0110】

また、反射層面に保護シートまたは基板を貼り合わせる、あるいは反射層面相互を内側とし対向させ、光記録媒体2枚を貼り合わせる等の手段を用いても良い。

【0111】

基板鏡面側に、表面保護やごみ等の付着防止のために紫外線硬化性樹脂、無機系薄膜等を成膜しても良い。

【0112】

また、図4のような光記録媒体を作製する場合、基板の上に、好ましくは $1\text{ nm} \sim 300\text{ nm}$ の厚さの反射層を形成する。反射率を高めるためや密着性をよくするために、記録層(A)と反射層の間に反射增幅層や接着層を設けることができる。反射層の材料としては、再生光の波長で反射率の十分高いもの、例えば、 Al 、 Ag 、 Ni および Pt の金属を単独あるいは合金にして用いることが可能である。この中でも Ag 、 Al は反射率が高く反射層の材料として適している。これ以外でも必要に応じて下記のものを含んでいても良い。例えば、 Mg 、 Se 、 Hf 、 V 、 Nb 、 Ru 、 W 、 Mn 、 Re 、 Fe 、 Co 、 Rh 、 Ir 、 Zn 、 Cd 、 Ga 、 In 、 Si 、 Ge 、 Te 、 Pb 、 Po 、 Sn 、 Bi 、 Au 、 Cu 、 Ti 、 Cr 、 Pd 、 Ta の金属および半金属を挙げることができる。 Ag または Al を主成分とするもので反射率の高い反射層が容易に得られるものが好適である。金属以外の材料で低屈折率薄膜と高屈折率薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射層として用いることも可能である。

【0113】

反射層を形成する方法としては、スパッタ法、イオンプレーティング法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられる。また、反射層の上に反射率の向上、記録特性の改善、密着性の向上等のために公知の無機系または有機系の中間層、接着層を設けることができる。

【0114】

次に、記録層(A)を反射層の上に製膜する際に、反射層の耐溶剤性や反射率、記録感度等を向上させるために、反射層の上に無機物やポリマーからなる層を設けても良い。

【0115】

記録層（A）を設ける方法は、スピンドル法、スプレー法、キャスト法、スライド法、カーテン法、エクストルージョン法、ワイヤー法、グラビア法、スプレッド法、ローラーコート法、ナイフ法、浸漬法等の塗布法等が挙げられるが、スピンドル法が簡便で好ましい。

【0116】

スピンドル法等の塗布法を用いる場合には本発明に係る有機化合物を1～40質量%、好ましくは3～30質量%となるように溶媒に溶解あるいは分散させた塗布液を用いるが、この際、溶媒は反射層にダメージを与えないものを選ぶことが好ましい。塗布法に用いる溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、アリルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、テトラフルオロプロパノール、オクタフルオロペンタノール等のアルコール系溶媒、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン等の脂肪族または脂環式炭化水素系溶媒、トルエン、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、四塩化炭素、クロロホルム、テトラクロロエタン、ジブロモエタン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン等のエーテル系溶媒、アセトン、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブタノン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、乳酸メチル等のエステル系溶媒、水等が挙げられる。これらは単独で用いても良く、あるいは、複数混合しても良い。好ましい溶剤としては、大気圧下での沸点が150℃以下のものが、塗布後の乾燥が速く、本発明の光記録媒体を製造する上で好ましい。さらには、大気圧下での沸点が150℃以下のアルコール系溶媒、特にフッ素置換アルコールがより好ましい。具体的にはテトラフルオロプロパノール、オクタフルオロペンタノールが好適な例として挙げられる。

【0117】

記録層（A）の膜厚は、通常1nm～1000nmであるが、好ましくは5nm～300nmである。記録層（A）の膜厚を1nmより薄くすると、記録できないか、記録信号に歪が発生する上、信号振幅が小さくなる場合がある。また、膜厚が1000nmより厚い場合は反射率が低下し、再生信号特性が悪化する場合がある。

【0118】

ここで、記録層（A）における本発明に係る有機化合物の含有量は、記録再生が可能な任意の量を選択することができるが、通常、30質量%以上、好ましくは60質量%以上である。尚、実質的に100質量%であることも好ましい。本発明に係る有機化合物として好適な化合物としては上述の式（1）の化合物が挙げられる。

【0119】

さらに、記録層（A）の上に形成する保護層の材料としては記録層（A）を外力や雰囲気等、外部からの悪影響保護するものであれば特に限定しない。無機物質としては、SiO₂、Si₃N₄、MgF₂、AlN、SnO₂、TiO₂等が挙げられる。また、有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂等を挙げることができる。熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等は適当な溶媒に溶解して塗布液を調製した後に、この塗布液を塗布し、乾燥することによって形成することができる。紫外線硬化性樹脂はそのままもしくは適当な溶媒に溶解して塗布液を調製した後にこの塗布液を塗布し、紫外線を照射して硬化させることによって形成することができる。紫外線硬化性樹脂としては、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート等のアクリレート樹脂を用いることができる。これらの保護層に用いる材料は単独であるいは混合して用いても良く、1層だけでなく多層膜にして用いても良い。

【0120】

保護層の形成の方法としては、記録層（A）と同様にスピンドル法やキャスト法等の塗布法やスパッタ法や化学蒸着法等の方法が用いられるが、この中でもスピンドル法が好ましい。なお、記録層にダメージを与えない溶媒を選択できない場合は、記録層を形成する際の条件と同様に、スパッタ法、化学蒸着法や真空蒸着法等が挙げられる。また、特

開平11-273147号公報に記載されているように、感圧性粘着シートまたはドライフォトポリマーシートなどの接着層を介して保護層を形成、あるいは感圧性粘着シートまたはドライフォトポリマーシート自体を保護層に用いることも可能である。

【0121】

さらに、保護層を記録層（A）の上に製膜する際に、記録層の耐溶剤性や反射率、記録感度等を向上させるために、記録層（A）の上に無機物やポリマーからなる層を設けても良い。

【0122】

保護層の膜厚は、一般には $0.01\mu\text{m} \sim 1000\mu\text{m}$ の範囲であるが、場合により $0.1\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ 、さらには、 $1\mu\text{m} \sim 20\mu\text{m}$ とすることができる。

【0123】

また、基板面に保護シートまたは反射層を張り合わせる、あるいは基板面相互を内側とし対向させ、光記録媒体2枚を張り合わせる等の手段を用いても良い。

【0124】

保護層面側に、表面保護やごみ等の付着防止のために紫外線硬化性樹脂、無機系薄膜等を製膜しても良い。

【0125】

本発明の光記録媒体において、媒体全体を保護する目的で、例えば、フレキシブルディスクや光磁気ディスク等に見られるようにディスクを保護するケース型の保護ユニットを設置しても構わない。材質はプラスチックや、アルミニウム等の金属を使用することができる。

【0126】

基材の材質としては、基本的には記録光および再生光の波長で透明であればよい。支持基板の材質としては、図5に示すように基板11を通じて青紫色レーザーの照射が行われる場合も加味すると、アクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料やガラス等の無機材料等の透明な材料が利用される。一方、図6に示す構成のように、基板11'からは逆の光透過層15'側からレーザー照射が行われる場合、基板の材質としては光学的諸要件を満たす必要はなく、より広範な材料から選択することができる。基板に要求される機械的特性、また基板生産性の観点からは、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂等の射出成型或いはキャスト成型可能な材料が好ましい。これらの基板材料は射出成形法等により円盤状に基板に成形してもよい。

【0127】

また、必要に応じて、これらの基板の表層には、サブミクロンオーダーの案内溝及び／又はプレピットが螺旋状又は同心円上に形成されていても良い。これら案内溝及びプレピットは、基板形成時に付与されているのが好ましく、スタンパー原盤を用いての射出成型や、フォトポリマーを用いた熱転写法により付与することができる。尚、図6における光透過層15'に案内溝及び／又はプレピットを形成しても良く、付与する場合も同様の方法を適用できる。案内溝のピッチ及び深さは、DVDよりも高密度記録を行うHD-DVD-Rの場合、ピッチとして $0.25 \sim 0.80\mu\text{m}$ 、深さとして $20 \sim 150\text{nm}$ の範囲から選択するのが好ましい。

【0128】

通常、光ディスクとして用いる場合は、厚さ1.2mm程度、直径80ないし120mm程度の円盤状であってもよく、中央に直径15mm程度の穴が開いていても構わない。

【0129】

本発明の光記録媒体は、波長 $300\text{nm} \sim 900\text{nm}$ から選択される記録レーザー波長および再生レーザー波長に対して記録再生が可能であり、中でも、波長 $390\text{nm} \sim 430\text{nm}$ 、更には波長 $400\text{nm} \sim 410\text{nm}$ の範囲から選択される記録レーザー波長および再生レーザー波長に対して良好なC/N比を得ることができ、また、再生光安定性も良く、高品位な信号特性が得られるものである。

【0130】

ここで、本発明で言う波長300nm～900nmのレーザーは、特に制限はないが、可視光領域の広範囲で波長選択のできる色素レーザーや、窒素レーザー(337nm)等のガスレーザー、波長445nmのヘリウムカドミウムレーザー、波長457nmあるいは波長488nmのアルゴンレーザー等のイオンレーザー、波長400～410nmのGaN系レーザー、CrドープしたLiSnAlF₆を用いた波長860nmの赤外線レーザーの第2高調波430nmを発振するレーザー、He-Neレーザー(633nm)他、波長415nm、425nm、602nm、612nm、635nm、647nm、650nm、660nm、670nm、680nm、780nm、830nm等の可視半導体レーザー等の半導体レーザー等があげられる。本発明では、前述のレーザー等を記録または再生を行う記録層の感應する波長に応じて適宜選択することができる。高密度記録および再生は各々、前述の該レーザー、更には波長430nm以下のレーザー、特に波長410nm以下のレーザーから選択される1波長または複数波長を用いることが好ましい。

【0131】

また、レーザー光の記録パワーとしては、特に制限はないが、より小さいパワーが好ましい。本発明に係る記録層(A)の記録レーザーパワーとして、通常10mW以下、好ましくは8mW以下、さらには6mW以下が好適な例として挙げられる。また、レーザー光の再生パワーとしては、特に制限はないが、より小さいパワーが好ましい。本発明に係る記録層(A)の再生レーザーパワーとして、通常2mW以下、好ましくは1mW、さらには0.7mW以下が好適である。

【0132】

以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれによりなんら限定されるものではない。

【実施例1】

【0133】

例示化合物番号A-1の化合物0.2gを2,2,3,3-テトラフルオロ-1-プロパノール10mlに溶解し、化合物溶液を調製した。

【0134】

ポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ: 0.6μm)を有する外径120mmφ、厚さ0.6mmの円盤状の基板上に、この化合物溶液を回転速度1500min⁻¹でスピンドルコートし、70℃で3時間乾燥して、記録層を形成した。この記録層上にバルザース社製スパッタ装置(CDI-900)を用いて銀をスパッタし、厚さ120nmの反射層を形成した。スパッタガスにはアルゴンガスを用いた。スパッタ条件は、スパッタパワー3.75kW、スパッタガス圧1.06Pa(8.0×10^{-3} Torr)で行った。

【0135】

さらに反射層の上に紫外線硬化樹脂「SD-1700」(大日本インキ化学工業製)をスピンドルコートした後、紫外線照射して厚さ5μmの保護層を形成した。更に、保護層の上に紫外線硬化樹脂デフライト「KZ-8681」(JSR株式会社製)をスピンドルコートした後、前記基板と同様なポリカーボネート樹脂基板(ダミー板)をのせ、紫外線照射して基板を貼り合わせ、光記録媒体を2枚作製した。

【0136】

以上のようにして記録層が形成された光記録媒体について、1枚は未記録のままダミー板・接着層・保護層・銀反射膜を剥離し色素層を露出させ、これを適当な切片に裁断し分光光度計(島津製作所製:型式=UV-1600)で300nmから500nmまでの波長域での吸光度を測定したところ、吸収極大波長=368nm、405nmでの吸光度=0.18であった。また、もう1枚は、以下のように評価試験を行った。

【0137】

波長405nm、開口数0.65の青色レーザーヘッドを搭載した評価機(パルステック工業製:型番DDU-1000)により、クロック周波数33MHz、線速度3.8m

/s にて 1 - 7 変調方式のランダム信号パターンデータを使用し、記録レーザーパワー 4.8 mW にて溝中（グループ）に記録を行ったところ良好な形状のマークが形成され、高密度に記録できた。

【0138】

記録後、同評価機により再生パワー 0.4 mW にて再生を行ったところ、反射率 = 22 %、信号変調度 = 0.45、解像度 = 0.21 であった。単一トラック記録再生ジッターおよび 3 連続トラック記録再生ジッターの差は 1 % 未満であり、隣接トラックへのクロスライトが殆どなく、マルチトラック特性が非常に優れていることが確認できた。

【0139】

次にこの光記録媒体の全周に亘って、オン・オフの変調をかけずに 4.8 mW の一定レーザーパワーにて溝中（グループ）と溝間（ランド）の両方に連続記録し、ダミー板・接着層・保護層・銀反射膜を剥離し色素層を露出させた。これを適当な切片に裁断し分光光度計（島津製作所製：型式 = UV-1600）で 300 nm から 500 nm までの波長域での吸光度を測定したところ、吸収極大波長が 393 nm に移動しており（移動波長 = 25 nm）記録再生を行った 405 nm での吸光度が 0.21 に増大していた。

【実施例 2】

【0140】

実施例 1において、記録層の形成に際して、例示化合物番号 A-1 の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号 A-2 の化合物を使用した以外は、実施例 1 に記載の方法により光記録媒体を 2 枚作製し、実施例 1 と同様に 1 枚を未記録のままダミー板・接着層・保護層・銀反射膜を剥離し色素層を露出させ、これを適当な切片に裁断し分光光度計（島津製作所製：型式 = UV-1600）で 300 nm から 500 nm までの波長域での吸光度を測定したところ、吸収極大波長 = 368 nm、405 nm での吸光度 = 0.20 であった。また、もう 1 枚について実施例 1 と同様に記録評価した結果、良好な形状のマークが形成された。また、単一トラック記録再生ジッターおよび 3 連続トラック記録再生ジッターの差は 1 % 未満であり、隣接トラックへのクロスライトが殆どなく、マルチトラック特性が非常に優れていることが確認できた。

【0141】

次にこの光記録媒体を実施例 1 と同様な処理を施し色素層を露出させた。これを分光光度計で測定したところ、吸収極大波長が 395 nm に移動しており（移動波長 = 27 nm）記録再生を行った 405 nm での吸光度が 0.22 に増大していた。

【0142】

実施例 1 ~ 2 に記載されるように、本発明の光記録媒体は、青色レーザー波長領域において、記録再生が可能であり、マルチトラックでの記録特性に優れている。

【0143】

のことから、本発明で規定する構造の化合物を含有する記録層は、波長 300 ~ 900 nm から選択されるレーザー光による信号記録が可能であり、本発明の光記録媒体は波長 300 ~ 900 nm から選択されるレーザー光を記録再生に用いる光記録媒体に用いることができる。

【産業上の利用可能性】

【0144】

本発明によれば、本発明の有機化合物を記録層に用いることにより、高密度光記録媒体として非常に注目されている波長 300 ~ 900 nm レーザー、さらには波長 390 ~ 430 nm のレーザー、特に波長 400 ~ 410 nm 青紫色レーザーでの、媒体の全周に亘って良好な記録および再生が可能であり、情報記録の大容量化に関して真に実用的な光記録媒体を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0145】

【図 1】本発明の課題を説明する概念図である。

【図 2】本発明の光記録媒体の一構成例を示す模式図である。

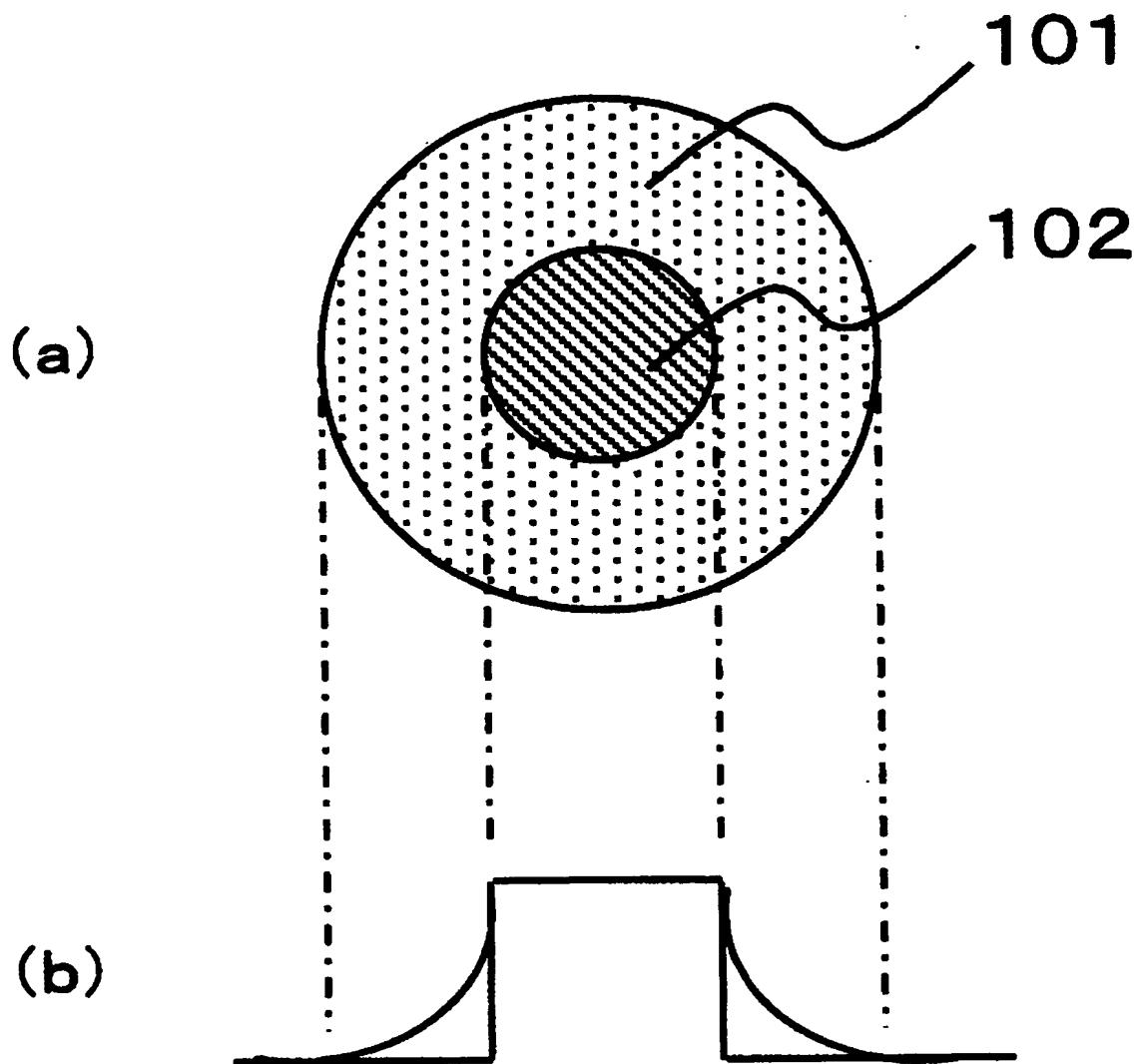
【図3】本発明の光記録媒体の他の一構成例を示す模式図である。
【図4】本発明の光記録媒体の更に他の一構成例を示す模式図である。
【図5】本発明の光記録媒体の他の一構成例を示す模式図である。
【図6】本発明の光記録媒体の更に他の一構成例を示す模式図である。
【図7】本発明の光記録媒体の他の一構成例を示す模式図である。

【符号の説明】

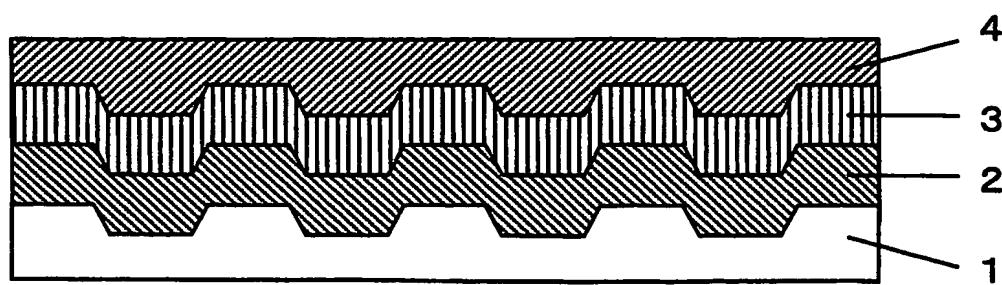
【0146】

1 : 基板
2 : 記録層
3 : 反射層
4 : 保護層
5 : 接着層
1 1 : 基板
1 2 : 記録層
1 3 : 反射層
1 4 : 保護層
1 5 : ダミー基板層
1 1' : 支持基板
1 2' : 記録層
1 3' : 反射層
1 4' : 透明保護層
1 5' : 光透過層
2 1 : 支持基板
2 2 : 記録層
2 3 : 窒化物層
2 4 : 酸化物層
2 5 : 光透過層
4 0 : 誘電体層
1 0 1 : ビームスポット
1 0 2 : 記録マーク

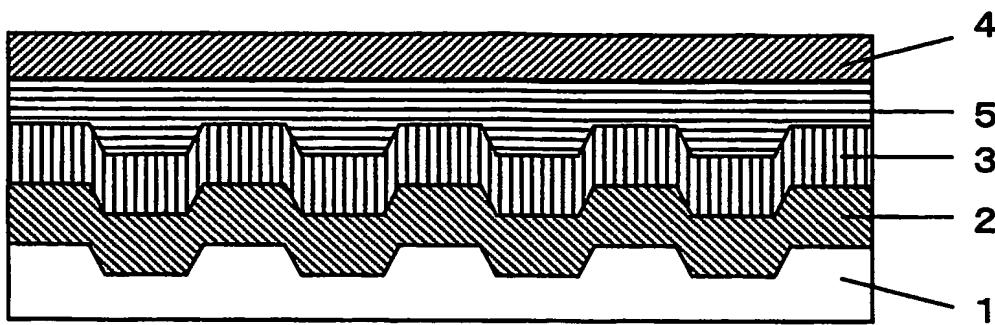
【書類名】 図面
【図 1】



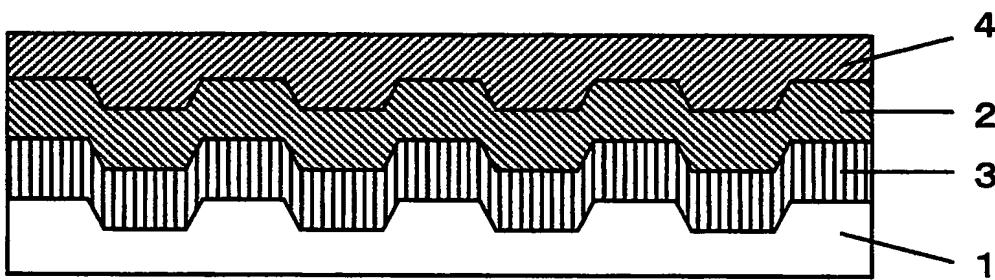
【図 2】



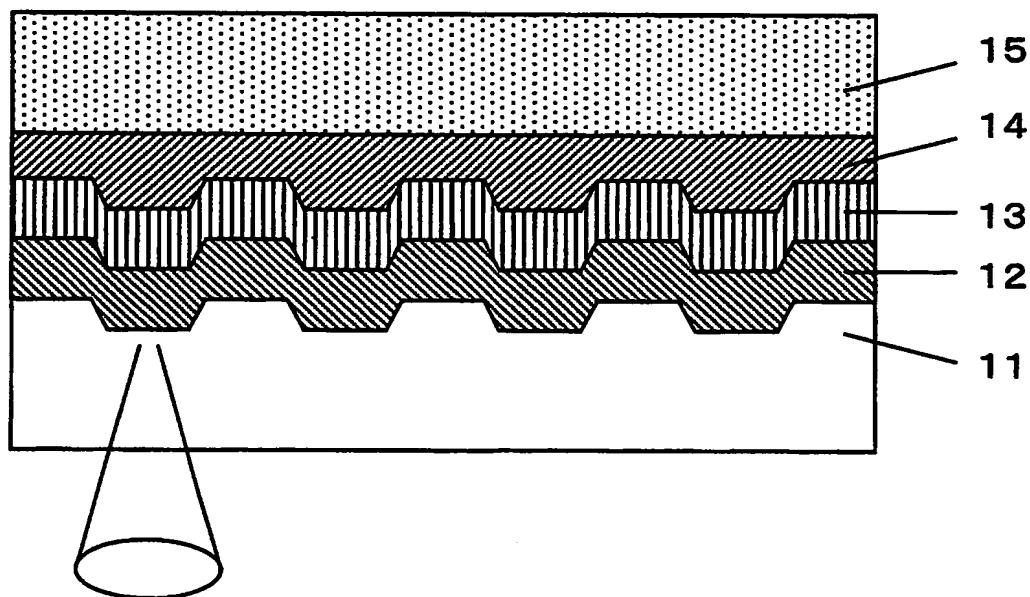
【図3】



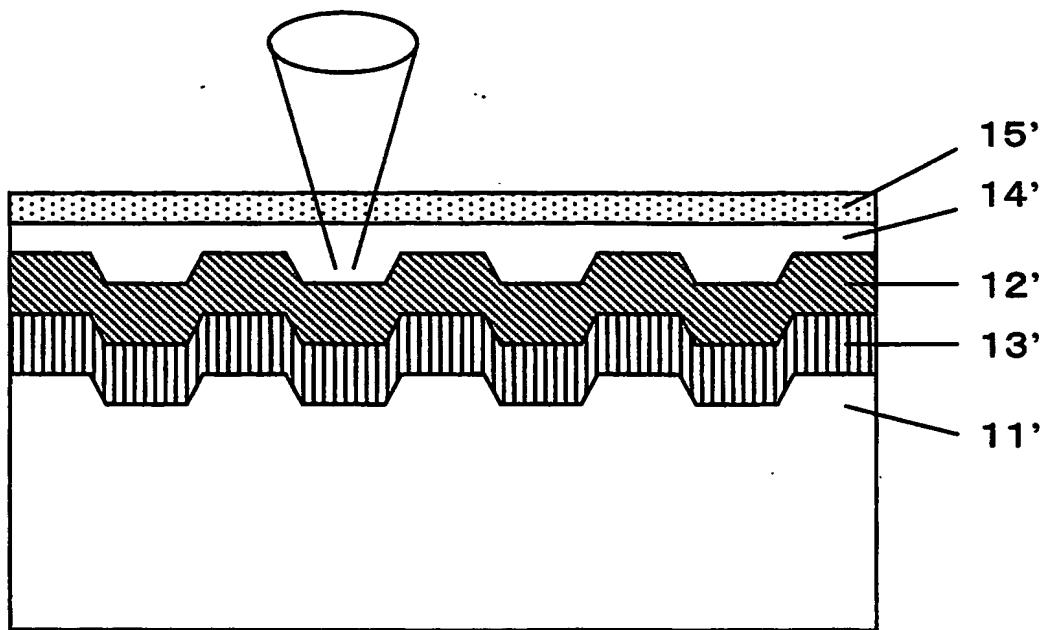
【図4】



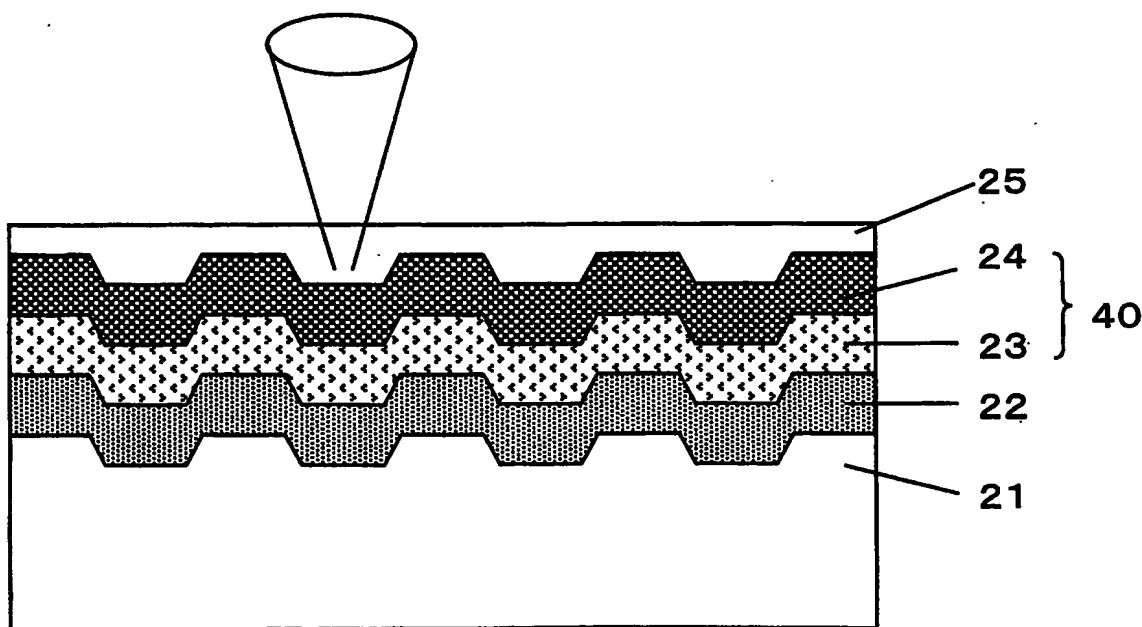
【図5】



【図6】



【図7】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 波長300～900nmのレーザーで良好な記録および再生が可能な光記録媒体および新規な組成物を提供する。

【解決手段】 記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{\max}^2 ）を記録後に与える有機化合物を記録層に含有する光記録媒体。また、記録レーザー光の照射によって、該記録層（A）の記録前の吸収極大波長（ λ_{\max}^1 ）とは異なる吸収極大波長（ λ_{\max}^2 ）を記録後に与える有機化合物を少なくとも1種含有する組成物。

【選択図】 なし

特願 2004-136659

出願人履歴情報

識別番号 [000005887]

1. 変更年月日 2003年11月 4日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区東新橋一丁目5番2号

氏 名 三井化学株式会社